# Trennungsabstandsberechnung unter Berücksichtigung der transienten Vorgänge im Erdsystem mit GSA-FD Version 6.4.1

Prof.Dr.-Ing.Jan Meppelink Soest

Version 01/12/2015

# Zusammenfassung der Ergebnisse

Der Trennungsabstand wird durch den negativen Erstblitz 1/200 bestimmt und nicht durch den in IEC 62305-3 zugrunde gelegten negativen Folgestoßstrom 0,25/100.

Die Trennungsabstandsberechnung in IEC 62305-3 basiert auf einer künstlich festgelegten magnetischen Kopplung in Luft mit einer Gegeninduktivität von 1,2µH/m, die einer Näherungsleitung in einem Abstand von 2 m zur Ableitung entspricht. Die Vorgänge einer innerhalb der Erde angeschlossenen Näherungsleitung ist nicht berücksichtigt.

Das Programm GSA\_FD berechnet eine IEC-Anordnung (Reine Luftnäherung ) korrekt. Dabei werden die Heidlerschen Stoßstromfunktionen durch Sinusförmige Ströme nachgebildet. Bei der Sinus-Nachbildung (314kA/µs)ergeben sich etwa 10 % größere Trennungsabstände gegenüber der Heidlerfunktion (280kA/µs).

Bei komplexeren Trennungsanordungen ist die Spannung an der Näherungsstelle bestimmt durch:

- Magnetisch eingekoppelte Spannung aller Ströme oberhalb Erde und innerhalb des Erdreichs. Innerhalb des Erdreichs sind die Ströme durch Abfluss in das Erdreich stark ortsabhängig.
- Kapazitive Kopplung zwischen allen Leitungen, auch innerhalb des Erdreichs
- Galvanische Kopplung bei größeren Abständen der Einführungspunkte der Ströme von der Ableitung und Näherung.
- Strahlungskopplung (Wird in GSA\_FD nicht berücksichtigt)

Für ein Modellgebäude 45mx15mx10m mit einem 1,5mx1,5m Maschegitter in 0,25 m Tiefe ergeben sich folgende Trennungsabstände:

- a) Näherung entsprechend IEC62305-3 in 2 m Abstand von der Ableitung bis zur Tiefe von 0,25 m im Erdreich:
  - a. 0,25/100: Trennungsabstände 1,5-fach größer als nach IEC 62305-3 berechnet
  - b. 1/200: Trennungsabstände etwa doppelt so groß gegenüber IEC 62305-3
- b) Näherung in ca. 45 m Abstand in 0,25m Tiefe geerdet:
  - a. 0,25/100: Trennungsabstand im Erdreich 1,8-fach größer als nach IEC 62305-3 berechnet
  - b. 1/200: Trennungsabstand im Erdreich 2,4-fach größer als nach IEC 62305-3 berechnet

Die größeren Trennungsabstände bei 1/200 resultieren aus der Stoßkennlinie für Luftfunkenstrecken. Beispielsweise gilt für 0,25/100 Klasse 1 mit 50 kA und 1/200 für Klasse 1 ein Verhältnis der Stromsteilheiten von 200/100 kA/µs von 2. Die Festigkeit aus der Stoßkennlinie fällt aber nicht von 3MV/m auf 1,5 MV/m sondern auf nur 1,2 MV/m. Daher ist der negative Erstblitz der für den Trennungsabstand maßgebliche Stoßstrom. In IEC 62305-3 ist das aber nicht realisiert worden.

Für die Klärung von Schadensfällen und Gutachten ist das Ergebnis dieser Studie von Bedeutung. Gerade die Schadensfälle an Gebäuden mit Reetdächern erscheinen unter Berücksichtigung der Ergebnisse dieser Studie in einem neuen Licht.

Die Ergebnisse decken sich vom Trend her mit der Veröffentlichung von Heidler/Zischank für den kritischen Eckeinschlag.



Bild 1-1 Trennungsabstände berechnet mit GSA\_FD Version 6.4.1. Gebäude nach Bild 1-2. Ergebnis einer grundsätzlichen Untersuchung der Vergleichbarkeit mit der Methode nach IEC 62305-3.



Bild 1-2 Anordnung mit Näherung nach IEC 62305-3



Bild 1-3 Trennungsabstände berechnet mit GSA\_FD Version 6.4.1 mit 314 kA/µs bzw. 1 MHz für 0,25/100, 50 kA und 157 kA/µs bzw. 0,25 MHz für 1/200, 100 kA Gebäude nach Bild 1-5. Diese Berechnung erfolgte mit der Annäherung des Heidlerimpulses durch eine Sinusfunktion.



Bild 1-4 Anordnung mit Näherung nach IEC 62305-3



Bild 1-5 Anordnung mit großer Näherung.

# Inhalt

2       STAND DER WISSENSCHAFT       7         3       NORMATIVER BEZUG       7         4       BERECHNUNGSMETHODE GSA       7         5       UNTERSUCHTE GEOMETRIEN       10         5.1       ÜBERPRÖFUNG DER IEC-62305-3- METHODE ZUR TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINER       11         5.1.1       GRUNDLAGE DER IEC-62305-3- BERECHNUNG       11         5.1.2       BERECHNUNG MIT CASA FD VERSION 6.4.1       12         5.1.3.1       Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung oberhalb der       17         5.1.3.2       Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung 0,25 m       11         5.1.3.3       Ergebnisvergleich       21         5.1.4       Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung 0,25 m       11         5.1.4       Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314 kA/µs       23         5.1.4       Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs       26         5.1.4       Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100       31       31         5.1.4       Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100       34       32.1         5.1.4       Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100       34       32.1       34         5.2.1	1 ZIEL DIESER UNTERSUCHUNG	7
3       NORMATIVER BEZUG       7         4       BERECHNUNGSMETHODE GSA       7         5       UNTERSUCHTE GEOMETRIEN       10         5.1       ÜBERPRÖFUNG DER IEC-62305-3- METHODE ZUR TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINER         EINZELINA ABLEITUNG       11         5.1.3       GRUNDLAGE DER IEC-62305-3- BERECHNUNG       11         5.1.3       KONTROLLE DES GSA, FD-PROGRAMMS       12         5.1.3.1       Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung oberhalb der Erde       17         5.1.3.2       Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung 0,25 m       11         5.1.3.3       Ergebnisvergleich       21         5.1.4.4       Eine Ableitung mit einem Robundschttren Und Potentialanschluss der Näherung UNTERHALB DER       23         5.1.4.2       Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 314 kA/μs       23         5.1.5       Verdelicht Der BEREGENISSE       30         5.2.1       TEENNUNGABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE       31         5.1.4       Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100       34         5.2.1.1       Modellgeometrie       31         5.2.1.2       Simulationsergebnissee für 1000 0hnm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314kA/μs       34         5.2.1.2       <	2 STAND DER WISSENSCHAFT	7
4       BERECHNUNGSMETHODE GSA       7         5       UNTERSUCHTE GEOMETRIEN       10         5.1       ÜBERPRÖFUNG DER IEC-62305-3- BERECHNUNG       11         5.1.1       GRUNDLAGE DER IEC-62305-3- BERECHNUNG       11         5.1.2       BERECINNUNG MT GSA_PD VERSION 6.4.1       12         5.1.3.1       Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung oberhalb der       17         5.1.3.2       Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung 0,25 m       11         5.1.3.3       Ergebnisvergleich       21         5.1.3.4       Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung 0,25 m       11         5.1.4       Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung 0,25 m       17         5.1.3.3       Ergebnisvergleich       21         5.1.4       Enrechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314 kA/µs       23         5.1.4       Berechnung für Klasse 1, 100 kA 1/200, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs       26         5.2       TERENNURGARSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GERÄUDE       31         5.2.1.1       Modellgeometrie       31         5.2.1.2       Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314 kA/µs       34         5.2.1.2.3       Simulati	3 NORMATIVER BEZUG	7
5UNTERSUCHTE GEOMETRIEN105.1ÜBERPRÜFUNG DER IEC-62305-3- METHODE ZUR TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEREINZELNEN ABLETTUNG115.1.2GRUNDLAGE DER IEC-62305-3- BERECHNUNG115.1.3GRUNDLAGE DER IEC-62305-3- BERECHNUNG125.1.3KONTROLLE DES GSA, FD-PROGRAMMS125.1.3.1Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung oberhalb derErde125.1.3.2Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung 0,25 munterhalb der Erde175.1.3.3Ergebnisvergleich215.1.4.1Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 314 kA/µs235.1.4.2Berechnung für Klasse 1, 100 kA 1/200, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs305.2TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE315.2.1.1BERECHNUNG MIT GEOMETRIE NACH HINTERGRUND DER IEC 62305-3315.2.1.2Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100345.2.1.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314kA/µs385.2.1.3BERECHNUNG MIT GEOMETRIE NACH HINTERGRUND DER IEC 62305-3315.2.1.4Vergleich der Ergebnissee455.2.1.5Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314kA/µs385.2.1.3Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs425.2.2.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs505.2.2.3Simulationsergebnissee für 1000 Ohm	4 BERECHNUNGSMETHODE GSA	7
5.1       ÜBERPRÖFUNG DER IEC-62305-3- METHODE ZUR TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINER         EINZELNEN ABLEITUNG       11         5.1.1       GRUNDLAGE DER IEC-62305-3- BERECHNUNG       11         5.1.2       BERECHNUNG MIT GSA_FD VERSION 6.4.1       12         5.1.3.1       Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung oberhalb der       12         5.1.3.2       Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung 0.25 m       11         5.1.3.2       Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung 0.25 m       17         5.1.3.2       Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung 0.25 m       17         5.1.4       EINE Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung 0.25 m       17         5.1.4       EINE Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung 0.25 m       17         5.1.4       Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung 0.25 m       17         5.1.4       Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung 0.25 m       17         5.1.4       Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung 0.25 m       17         5.1.4       Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung 0.25 m       17         5.1.4       Derechnung für Klasse 1, 5	5 UNTERSUCHTE GEOMETRIEN	10
EINZELNEN ABLETTUNG 11 5.1.1 GRUNDLAGE DER IEC-62305-3-BERECHNUNG 11 5.1.2 BERCENNUNG MIT CSA, FD VERSION 6.4.1 12 5.1.3 KONTROLLE DES GSA, FD-PROGRAMMS 12 5.1.3.1 Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung oberhalb der Erde 12 5.1.3.2 Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung 0,25 m unterhalb der Erde 17 5.1.3.3 Ergebnisvergleich 21 5.1.4.1 Erne Ableitung mit einem ERDUNGSGITTER UND POTENTIALANSCHLUSS DER NÄHERUNG UNTERHALB DER ERDE 21 5.1.4.1 Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314 kA/µS 23 5.1.4.2 Berechnung für Klasse 1, 100 kA 1/200, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157 kA/µS 26 5.1.5 VERCLEICH DER ERGEBNISSE 30 5.2.1 BERECHNUNG MIT EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE 31 5.2.1 BERECHNUNG MIT GEOMETRIE NACH HINTERGRUND DER IEC 62305-3 31 5.2.1.1 Modellgeometrie 31 5.2.1.2 BERECHNUNG MIT GEOMETRIE NACH HINTERGRUND DER IEC 62305-3 31 5.2.1.2 Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314kA/µS 34 5.2.1.2.2 Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314kA/µS 34 5.2.1.3 Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µS 40 5.2.1.3 Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µS 40 5.2.1.4 Vergleich der Ergebnisse für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µS 40 5.2.1.3 Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µS 40 5.2.1.4 Vergleich der Ergebnisse für 1000 Ohmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µS 50 5.2.2 TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE MIT NÄHERUNG IN GROßEM ABSTAND VON DER ABLETTUNG 48 5.2.2.2 Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µS 50 5.2.2.3 Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µS 50 5.2.2.4 Vergleich der Ergebnisse 65 5.2.2.4 Vergleich der Ergebnisse 65 7.2.2.3 Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µS 60 5.2.2.3.1 Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/	5.1 ÜBERPRÜFUNG DER IEC-62305-3- METHODE ZUR TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINER	
5.1.1       GRUNDLAGE DER IEC-62305-3- BERECHNUNG       11         5.1.2       BERECHNUNG MIT GSA_FD VERSION 6.4.1       12         5.1.3       KONTROLLE DES GSA_FD-PROGRAMMS       12         5.1.3.1       Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung oberhalb der         Erde       12         5.1.3.2       Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung 0,25 m         unterhalb der Erde       17         5.1.3.3       Ergebnisvergleich       21         5.1.4       Eine Ableitruns (MIT EINEM ERDUNGSGITTER UND POTENTIALANSCHLUSS DER NÄHERUNG UNTERHALB DER       21         5.1.4       Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs       26         5.1.4       Berechnung für Klasse 1, 100 kA 1/200, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs       26         5.2.1       BERCHNUNG ANETRECHNUG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE       31         5.2.1       BERCHNUNG KIT GROMETRIE NACH HINTERGRUND DER IEC 62305-3       31         5.2.1.1       Modellgeometrie       31         5.2.1.2       Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314 kA/µs       34         5.2.1.2.1       Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs       40         5.2.1.3.1       Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 1,025 MHz bzw.	EINZELNEN ABLEITUNG	11
5.1.2BERECHNUNG MIT GSA_FD VERSION 6.4.1125.1.3KONTROLLE DES GSA_FD-PROGRAMMS125.1.3.1Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung oberhalb der175.1.3.2Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung 0,25 m175.1.3.3Ergebnisvergleich215.1.4EINE ABLEITUNG MIT EINEM ERDUNGSGITTER UND POTENTIALANSCHLUSS DER NÄHERUNG UNTERHALB DER235.1.4.1Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314 kA/µs235.1.4.2Berechnung für Klasse 1, 100 kA 1/200, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs265.2TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE315.2.1BERCCHNUNG MIT GEOMETRIE NACH HINTERGRUND DER IEC 62305-3315.2.1.1BERCCHNUNG MIT GEOMETRIE NACH HINTERGRUND DER IEC 62305-3315.2.1.2Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100345.2.1.3Isimulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314kA/µs385.2.1.3Berechnung für Klasse 1, 100 kA, 1/200405.2.1.3Berechnung für Klasse 1, 100 kA, 1/200405.2.1.4Vergleich der Ergebnissee455.2.2TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE MIT NÄHERUNG IN GROßEM ABSTAND405.2.2.1Nodellgoometrie485.2.2TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE MIT NÄHERUNG IN GROßEM ABSTAND505.2.2.1Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 1, MHz bzw. 314 kA/µs505.2.2TRENNUNGSABSTANDSB	5.1.1 GRUNDLAGE DER IEC-62305-3- BERECHNUNG	11
5.1.3KONTROLLE DES GSÄ_FD-PROGRAMMS125.1.3.1Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung oberhalb derErde125.1.3.2Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung 0,25 munterhalb der Erde175.1.3.2Ergebnisvergleich21215.1.4Eine Ableitung MIT EINEM ERDUNGSGITTER UND POTENTIALANSCHLUSS DER NÄHERUNG UNTERHALB DERERDE215.1.4.1Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314 kA/µs235.1.4.2Berechnung für Klasse 1, 100 kA 1/200, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs26215.1.4Berechnung für Klasse 1, 100 kA 1/200, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314 kA/µs21.1BEREGHNUNG AM EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE31315.2.1.2Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/10032.1.1Modellgeometrie31315.2.1.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314kA/µs345.2.1.35.2.1.3Berechnung für Klasse 1, 100 kA, 1/20032.1.4Vergleich der Ergebnissee33.2.1.1Modellgeometrie34405.2.2TRENNUNGSABSTANDSBERCHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE MIT NÄHERUNG IN GROBEM ABSTAND5.2.1.3Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs5.2.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs5.2.2.1Modellgeometrie5.2.2.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 1,2	5.1.2 BERECHNUNG MIT GSA_FD VERSION 6.4.1	12
5.1.3.1       Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung oberhalb der         Erde       12         5.1.3.2       Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung 0,25 m         unterhalb der Erde       17         5.1.3.3       Ergebnisvergleich       21         5.1.4       EINE ABLEITUNG MIT EINEM ERDUNGSGITTER UND POTENTIALANSCHLUSS DER NÄHERUNG UNTERHALB DER         ERDE       21         5.1.4.1       Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314 kA/µs       23         5.1.4       Berechnung für Klasse 1, 100 kA 1/200, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs       26         5.1.5       VERGLEICH DER ERGEBNISSE       30         5.2.1       TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE       31         5.2.1.1       Modellgeometrie       31         5.2.1.2       Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100       34         5.2.1.2       Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314kA/µs       34         5.2.1.2       Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs       42         5.2.1.3       Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs       42         5.2.1.4       Vergleich der Ergebnisse       45         5.2.2.1       Simulationsergebniss	5.1.3 KONTROLLE DES GSA_FD-PROGRAMMS	12
Erde125.1.3.2Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung 0,25 munterhalb der Erde175.1.3.3Ergebnisvergleich21215.1.4.1Enre Ableitung MIT EINEM ERDUNGSGITTER UND POTENTIALANSCHLUSS DER NÄHERUNG UNTERHALB DERS1.4.2Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 314 kA/µs23235.1.4.1Berechnung für Klasse 1, 100 kA 1/200, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs262627TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE3132.121.1Modellgeometrie32.1.1Modellgeometrie333423.1.2.1Simulationsergebnissee für 1000 hmm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314kA/µs3422.1.2.1Simulationsergebnissee für 1000 hmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs3432.1.335.2.1.4Vergleich der Ergebnisse35.2.1.4Vergleich der Ergebnissee3632.1.337Simulationsergebnissee für 1000 hmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs383939.2.1.3Simulationsergebnissee für 1000 hmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs3032.2.131Simulationsergebnissee für 1000 hmm, Sinusstrom 1,025 MHz bzw. 157kA/µs32.2TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE MIT NÄHERUNG IN GROBEM ABSTAND34S2.2.135.2.2.1Modellgeometrie35.2.2.1Modellgeometrie36S2.2.137Simulationsergebnissee fü	5.1.3.1 Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung oberhalb de	er
5.1.3.2Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung 0,25 m unterhalb der Erde175.1.3.3Ergebnisvergleich215.1.4Eine Ableitung Mit einem ERDUNGSGITTER UND POTENTIALANSCHLUSS DER NÄHERUNG UNTERHALB DER ERDE215.1.4.1Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 314 kA/µs235.1.4.2Berechnung für Klasse 1, 100 kA 1/200, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs265.1.5VERGLEICH DER ERGEBNISSE305.2.1BERECHNUNG MIT GEOMETRIE NACH HINTERGRUND DER IEC 62305-3315.2.1.1Modellgeometrie315.2.1.2Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100345.2.1.3Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100345.2.1.4Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314kA/µs345.2.1.3Berechnung für Klasse 1, 100 kA, 1/200405.2.1.3Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs405.2.1.3Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs425.2.2TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE MIT NÄHERUNG IN GROßEM ABSTAND485.2.2.1Vergleich der Ergebnisse455.2.2TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE MIT NÄHERUNG IN GROßEM ABSTAND505.2.2.1Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs505.2.2.1Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs505.2.2.2.1Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sin	Erde 12	
unterhalb der Erde 17 5.1.3.3 Ergebnisvergleich 21 5.1.4 EINE ABLEITUNG MIT EINEM ERDUNGSGITTER UND POTENTIALANSCHLUSS DER NÄHERUNG UNTERHALB DER ERDE 21 5.1.4.1 Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314 kA/µs 23 5.1.4.2 Berechnung für Klasse 1, 100 kA 1/200, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs 30 5.2 TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE 31 5.2.1 BERECHNUNG MIT GEOMETRIE NACH HINTERGRUND DER IEC 62305-3 31 5.2.1.2 Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100 34 5.2.1.2.1 Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314kA/µs 38 5.2.1.3 Berechnung für Klasse 1, 100 kA, 1/200 5.2.1.3.1 Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs 40 5.2.1.3.2 Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs 40 5.2.1.3.2 Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs 40 5.2.1.3.1 Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs 42 5.2.2.1 Voergleich der Ergebnisse für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs 45 5.2.2.1 Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs 45 5.2.2.1 Modellgeometrie 48 5.2.2.1 Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs 45 5.2.2.1 Modellgeometrie 48 5.2.2.1 Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 1,25 MHz bzw. 157kA/µs 50 5.2.2.2.1 Modellgeometrie 50 kA 0,25/100 50 5.2.2.1 Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 1, 1 MHz bzw. 314 kA/µs 50 5.2.2.3.2 Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 1, 1 MHz bzw. 157 kA/µs 54 5.2.2.3 Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100 50 5.2.2.4 Vergleich der Ergebnisse für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs 56 5.2.2.3.2 Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 1, 1 MHz bzw. 314 kA/µs 50 5.2.2.3.2 Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs 56 5.2.2.3.2 Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs 56 5.2.2.3.2 Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bz	5.1.3.2 Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung 0,25 m	
5.1.3.3Ergebnisvergleich215.1.4EINE ABLEITUNG MIT EINEM ERDUNGSGITTER UND POTENTIALANSCHLUSS DER NÅHERUNG UNTERHALB DERERDE215.1.4.1Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs265.1.5VERGLEICH DER ERGEBNISSE305.2TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE315.2.1.1Modellgeometrie315.2.1.2Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100345.2.1.1Modellgeometrie315.2.1.2Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100345.2.1.2.1Simulationsergebnissee für 100 0hmm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314kA/µs345.2.1.2.2Simulationsergebnissee für 100 0hmm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314kA/µs345.2.1.3Berechnung für Klasse 1, 100 kA, 1/200405.2.1.3Simulationsergebnissee für 100 0hmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs425.2.1.4Vergleich der Ergebnisse455.2.2TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE MIT NÄHERUNG IN GROBEM ABSTANDVON DER ABLEITUNG485.2.2.1Modellgeometrie485.2.2.2TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE MIT NÄHERUNG IN GROBEM ABSTANDVON DER ABLEITUNG505.2.2.2.1Simulationsergebnissee für 100 0hmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs505.2.2.2TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE MIT NÄHERUNG IN GROBEM ABSTAND505.2.2.3Simulationsergebnissee für 100 0hmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs50	unterhalb der Erde	17
5.1.4       EINE ABLEITUNG MIT EINEM ERDUNGSGITTER UND POTENTIALANSCHLUSS DER NÄHERUNG UNTERHALB DER         ERDE       21         5.1.4.1       Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs       26         5.1.4.2       Berechnung für Klasse 1, 100 kA 1/200, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs       26         5.1.4.2       Berechnung für Klasse 1, 100 kA 1/200, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs       26         5.2       TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE       31         5.2.1.1       Modellgeometrie       31         5.2.1.2       Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100       34         5.2.1.2.3       Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314kA/µs       34         5.2.1.3       Berechnung für Klasse 1, 100 kA, 1/200       40         5.2.1.3       Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs       40         5.2.1.3       Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs       42         5.2.1.4       Vergleich der Ergebnisse       45         5.2.2       TRENNUNGABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE MIT NÄHERUNG IN GROSEM ABSTAND       48         5.2.1.4       Vergleich der Ergebnisse       45         5.2.2       TRENNUNGABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE MIT NÄHERUNG IN GROSEM ABSTAND	5.1.3.3 Ergebnisvergleich	21
ERDE215.1.4.1Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314 kA/µs235.1.4.2Berechnung für Klasse 1, 100 kA 1/200, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs265.1.5VERGLEICH DER ERGEBNISSE305.2TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE315.2.1BERECHNUNG MIT GEOMETRIE NACH HINTERGRUND DER IEC 62305-3315.2.1.2Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100345.2.1.2Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100345.2.1.2Simulationsergebnissee für 100 0 0hmm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314kA/µs345.2.1.3Berechnung für Klasse 1, 100 kA, 1/200405.2.1.3Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs405.2.1.3Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs425.1.4Vergleich der Ergebnisse455.2.2TRENNUNGABERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE MIT NÄHERUNG IN GROBEM ABSTANDVON DER ABLETTUNG485.2.2.1Modellgeometrie485.2.2.2Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs505.2.2.2Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs505.2.2.2Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs565.2.2.3Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs565.2.2.3Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs565.2.2.3Simulationsergebnisse	5.1.4 EINE ABLEITUNG MIT EINEM ERDUNGSGITTER UND POTENTIALANSCHLUSS DER NÄHERUNG UNTERHAL	B DER
5.1.4.1Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314 kA/µs235.1.4.2Berechnung für Klasse 1, 100 kA 1/200, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs305.1.5VERCLEICH DER ERGEBNISSE305.2TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE315.2.1.1Modellgeometrie315.2.1.2Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100345.2.1.2.1Simulationsergebnissee für 100 0hmm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314kA/µs345.2.1.2.2Simulationsergebnissee für 100 0hmm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314kA/µs385.2.1.3Berechnung für Klasse 1, 100 kA, 1/200405.2.1.4Vergleich der Ergebnisse455.2.2.2Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs425.2.1.4Vergleich der Ergebnisse455.2.2TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE MIT NÄHERUNG IN GROßeM ABSTAND50VON DER ABLEITUNG485.2.2.1Modellgeometrie485.2.2.2Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs505.2.2.2Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 157 kA/µs505.2.2.2.1Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs545.2.2.2.2Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs505.2.2.2.3Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs605.2.2.2.4Vergleich der Ergebnisse636LITERATUR65	ERDE 21	
5.1.4.2Berechnung für Klasse 1, 100 kA 1/200, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs265.1.5VERGLEICH DER ERGEBNISSE305.2TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE315.2.1BERECHNUNG MIT GEOMETRIE NACH HINTERGRUND DER IEC 62305-3315.2.1.2Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100345.2.1.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314kA/µs385.2.1.3Berechnung für Klasse 1, 100 kA, 1/200405.2.1.3Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs405.2.1.4Vergleich der Ergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs405.2.1.3Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs405.2.1.4Vergleich der Ergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs405.2.2.1Vergleich der Ergebnisse455.2.2TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE MIT NÄHERUNG IN GROßEM ABSTAND485.2.2.1Modellgeometrie485.2.2.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs505.2.2.2.1Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs565.2.2.2.3Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs565.2.2.3.1Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs565.2.2.3.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs565.2.2.3.3Simulationsergebnissee für 10	5.1.4.1 Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314 kA/µs	23
5.1.5VERCLEICH DER ERGENISSE305.2TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE315.2.1BERECHNUNG MIT GEOMETRIE NACH HINTERGRUND DER IEC 62305-3315.2.1.2Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100345.2.1.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314kA/µs345.2.1.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314kA/µs385.2.1.3Berechnung für Klasse 1, 100 kA, 1/200405.2.1.3Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs405.2.1.4Vergleich der Ergebnisse455.2.2TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE MIT NÄHERUNG IN GROßEM ABSTAND48VON DER ABLEITUNG485.2.2.1Modellgeometrie485.2.2.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs505.2.2.1Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs505.2.2.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs505.2.2.2.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs565.2.2.3.1Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs565.2.2.3.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs565.2.2.3.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs565.2.2.3.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs565.2.2.4	5.1.4.2 Berechnung für Klasse 1, 100 kA 1/200, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157 kA/ $\mu$ s	26
5.2TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBAUDE315.2.1BERECHNUNG MIT GEOMETRIE NACH HINTERGRUND DER IEC 62305-3315.2.1.1Modellgeometrie315.2.1.2Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100345.2.1.3Berechnung für Klasse 1, 100 0hmm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314kA/µs385.2.1.3Berechnung für Klasse 1, 100 kA, 1/200405.2.1.4Vergleich der Ergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs405.2.1.3Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs425.2.1.4Vergleich der Ergebnisse455.2.2TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE MIT NÄHERUNG IN GROßEM ABSTAND485.2.2.1Modellgeometrie485.2.2.2Berechnung für Klasse 1 50 kA 0,25/100505.2.2.2.1Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs505.2.2.2Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 157 kA/µs505.2.2.2.3Berechnung für Klasse 1, 100 kA, 1/200565.2.2.3Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs565.2.2.3Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs605.2.2.4Vergleich der Ergebnisse636LITERATUR657ANHANG657.1KOPPLUNG ZWISCHEN ABLEITUNG UND DER NÄHERUNGSLEITUNG657.2STOßKENNLINIE FÜR TRENNUNGSANORDNUNG NACH ZISCHANK667.3ANALYTISCHE B	5.1.5 VERGLEICH DER ERGEBNISSE	30
5.2.1BERECHNUNG MIT GEOMETRIE NACH HINTERGRUND DER IEC 62305-3315.2.1.1Modellgeometrie315.2.1.2Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100345.2.1.2.1Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314kA/µs385.2.1.3Berechnung für Klasse 1, 100 kA, 1/200405.2.1.3.1Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs405.2.1.3.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs405.2.1.4Vergleich der Ergebnisse455.2.2TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE MIT NÄHERUNG IN GROßEM ABSTAND485.2.2.1Modellgeometrie485.2.2.2Berechnung für Klasse 1 50 kA 0,25/100505.2.2.2.3Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs545.2.2.4Modellgeometrie485.2.2.5Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs505.2.2.2.1Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs545.2.2.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs665.2.2.3.1Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs665.2.2.3.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs665.2.2.3.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs665.2.2.4Vergleich der Ergebnisse636LITERATUR657ANHA	5.2 TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBAUDE	31
5.2.1.1Modellgeometrie315.2.1.2Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100345.2.1.2.1Simulationsergebnissee für 100 0hmm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314kA/µs385.2.1.2.2Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom, 0,14kA/µs385.2.1.3Berechnung für Klasse 1, 100 kA, 1/200405.2.1.3.1Simulationsergebnissee für 100 0hmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs405.2.1.3.2Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs425.2.1.4Vergleich der Ergebnisse455.2.2TEENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE MIT NÄHERUNG IN GROßEM ABSTAND485.2.2.1Modellgeometrie485.2.2.2Berechnung für Klasse 1 50 kA 0,25/100505.2.2.2.1Simulationsergebnissee für 100 0hmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs505.2.2.2.2Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs505.2.2.3.3Berechnungen für Klasse 1, 100 kA, 1/200565.2.2.3.4Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs565.2.2.3.2Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs605.2.2.4Vergleich der Ergebnisse636LITERATUR657ANHANG657.1KOPPLUNG ZWISCHEN ABLEITUNG UND DER NÄHERUNGSLEITUNG657.2STOBKENNLINIE FÜR TRENNUNGSANORDNUNG NACH ZISCHANK667.3ANALYTISCHE BERECHNUNG DES TRENNUNGSABSTANDS AUS DER STOBKENNLINIE.70 <td>5.2.1 BERECHNUNG MIT GEOMETRIE NACH HINTERGRUND DER IEC 62305-3</td> <td>31</td>	5.2.1 BERECHNUNG MIT GEOMETRIE NACH HINTERGRUND DER IEC 62305-3	31
5.2.1.2Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100345.2.1.2.1Simulationsergebnissee für 100 0hmm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314kA/µs345.2.1.2.2Simulationsergebnissee für 100 0hmm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314kA/µs385.2.1.3Berechnung für Klasse 1, 100 kA, 1/200405.2.1.3.1Simulationsergebnissee für 100 0hmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs405.2.1.3.2Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs425.2.1.4Vergleich der Ergebnisse455.2.2TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE MIT NÄHERUNG IN GROßEM ABSTAND48VON DER ABLEITUNG485.2.2.1Borechnung für Klasse 1 50 kA 0,25/100505.2.2.2Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs505.2.2.2Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs505.2.2.2.1Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs545.2.2.2Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs565.2.2.3.1Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs665.2.2.3.2Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs665.2.2.3.2Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs665.2.2.3.2Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs665.2.2.3.4Vergleich der Ergebnisse636LITERATUR657ANHA	5.2.1.1 Modellgeometrie	31
5.2.1.2.1Simulationsergebnissee für 100 0hmm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314kA/µs345.2.1.2.2Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314kA/µs385.2.1.3Berechnung für Klasse 1, 100 kA, 1/200405.2.1.3.1Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs405.2.1.3.2Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs425.2.1.4Vergleich der Ergebnisse455.2.2TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE MIT NÄHERUNG IN GROßEM ABSTAND485.2.2.1Modellgeometrie485.2.2.2Berechnung für Klasse 1 50 kA 0,25/100505.2.2.2.2Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs505.2.2.2.2Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs545.2.2.2.2Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs545.2.2.3Berechnungen für Klasse 1, 100 kA, 1/200565.2.2.3.1Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs665.2.2.3.2Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs665.2.2.3.2Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs666LITERATUR657ANHANG657.1KOPPLUNG ZWISCHEN ABLEITUNG UND DER NÄHERUNGSLEITUNG657.2STO6KENNLINIE FÜR TRENNUNGSANORDNUG NACH ZISCHANK667.3ANALYTISCHE BERECHNUNG DES TRENNUNGSABSTANDS AUS DER STO6KEN	5.2.1.2 Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100	34
5.2.1.2.2Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314kA/µs385.2.1.3Berechnung für Klasse 1, 100 kA, 1/200405.2.1.3.1Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs405.2.1.3.2Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs425.2.1.4Vergleich der Ergebnisse455.2.2TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE MIT NÄHERUNG IN GROßEM ÅBSTAND485.2.2.1Modellgeometrie485.2.2.2Berechnung für Klasse 1 50 kA 0,25/100505.2.2.2.3Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs505.2.2.2.4Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom , 1 MHz bzw. 314 kA/µs545.2.2.3Berechnung für Klasse 1, 100 kA, 1/200565.2.2.3.1Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs565.2.2.3.2Simulationsergebnissee für 1000 0hmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs605.2.2.4Vergleich der Ergebnisse636LITERATUR657ANHANG657.1KOPPLUNG zwischen Ableitung und Der Näherungsleitung657.2Stoßkennlinie für Trennungsanordnung Nach Zischank667.3ANALYTISCHE BERECHNUNG DES TRENNUNGSABSTANDS AUS DER STOßKENNLINIE.70	5.2.1.2.1 Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314kA/µs	34
5.2.1.3Berechnung für Klasse 1, 100 kA, 1/200405.2.1.3.1Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs405.2.1.3.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs425.2.1.4Vergleich der Ergebnisse455.2.2TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE MIT NÄHERUNG IN GROßEM ABSTANDVON DER ABLEITUNG485.2.2.1Modellgeometrie485.2.2.2Berechnung für Klasse 1 50 kA 0,25/100505.2.2.2.1Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs505.2.2.2.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom , 1 MHz bzw. 314 kA/µs545.2.2.3Berechnungen für Klasse 1, 100 kA, 1/200565.2.2.3.1Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs605.2.2.3.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs605.2.2.4Vergleich der Ergebnisse636LITERATUR657ANHANG657.1KOPPLUNG ZWISCHEN ABLEITUNG UND DER NÄHERUNGSLEITUNG657.2STOBKENNLINIE FÜR TRENNUNGSANORDNUNG NACH ZISCHANK667.3ANALYTISCHE BERECHNUNG DES TRENNUNGSABSTANDS AUS DER STOßKENNLINIE.70	5.2.1.2.2 Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314kA/μs	38
5.2.1.3.1Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/μs405.2.1.3.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/μs425.2.1.3.2Simulationsergebnisse455.2.2TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE MIT NÄHERUNG IN GROßEM ABSTANDVON DER ABLEITUNG485.2.2.1Modellgeometrie485.2.2.2Berechnung für Klasse 1 50 kA 0,25/100505.2.2.2.1Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/μs505.2.2.2.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/μs545.2.2.3Berechnungen für Klasse 1, 100 kA, 1/200565.2.2.3.1Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/μs565.2.2.3.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/μs605.2.2.4Vergleich der Ergebnisse636LITERATUR657ANHANG657.1KOPPLUNG ZWISCHEN ABLEITUNG UND DER NÄHERUNGSLEITUNG657.2STOBKENNLINIE FÜR TRENNUNGSANORDNUNG NACH ZISCHANK667.3ANALYTISCHE BERECHNUNG DES TRENNUNGSABSTANDS AUS DER STOBKENNLINIE.70	5.2.1.3 Berechnung für Klasse 1, 100 kA, 1/200	40
5.2.1.3.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs425.2.1.4Vergleich der Ergebnisse455.2.2TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE MIT NÄHERUNG IN GROßEM ABSTANDVON DER ABLEITUNG485.2.2.1Modellgeometrie485.2.2.2Berechnung für Klasse 1 50 kA 0,25/100505.2.2.2.1Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs505.2.2.2.2Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, Sinusstrom 1 MHz bzw 314 kA/µs545.2.2.3Berechnungen für Klasse 1, 100 kA, 1/200565.2.2.3.1Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs605.2.2.3.2Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs605.2.2.4Vergleich der Ergebnisse636LITERATUR657ANHANG657.1KOPPLUNG ZWISCHEN ABLEITUNG UND DER NÄHERUNGSLEITUNG657.2STOßKENNLINIE FÜR TRENNUNGSANORDNUNG NACH ZISCHANK667.3ANALYTISCHE BERECHNUNG DES TRENNUNGSABSTANDS AUS DER STOßKENNLINIE.70	5.2.1.3.1 Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/μs	40
5.2.1.4Vergleich der Ergebnisse455.2.2TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE MIT NÄHERUNG IN GROßEM ABSTAND VON DER ABLEITUNG485.2.2.1Modellgeometrie485.2.2.2Berechnung für Klasse 1 50 kA 0,25/100505.2.2.2.1Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs505.2.2.2.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom , 1 MHz bzw 314 kA/µs545.2.2.3Berechnungen für Klasse 1, 100 kA, 1/200565.2.2.3.1Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs565.2.2.3.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs605.2.2.4Vergleich der Ergebnisse636LITERATUR657ANHANG657.1KOPPLUNG ZWISCHEN ABLEITUNG UND DER NÄHERUNGSLEITUNG657.2STOßKENNLINIE FÜR TRENNUNGSANORDNUNG NACH ZISCHANK667.3ANALYTISCHE BERECHNUNG DES TRENNUNGSABSTANDS AUS DER STOßKENNLINIE.70	5.2.1.3.2 Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/μs	42
5.2.2TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE MIT NÄHERUNG IN GROßEM ABSTAND VON DER ABLEITUNG48VON DER ABLEITUNG485.2.2.1Modellgeometrie485.2.2.2Berechnung für Klasse 1 50 kA 0,25/100505.2.2.2.1Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs505.2.2.2.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom , 1 MHz bzw 314 kA/µs545.2.2.3Berechnungen für Klasse 1, 100 kA, 1/200565.2.2.3.1Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs565.2.2.3.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs605.2.2.4Vergleich der Ergebnisse636LITERATUR657ANHANG657.1KOPPLUNG ZWISCHEN ABLEITUNG UND DER NÄHERUNGSLEITUNG SANORDNUNG NACH ZISCHANK667.3ANALYTISCHE BERECHNUNG DES TRENNUNGSABSTANDS AUS DER STOßKENNLINIE.70	5.2.1.4 Vergleich der Ergebnisse	45
VON DER ABLEITUNG485.2.2.1Modellgeometrie485.2.2.2Berechnung für Klasse 1 50 kA 0,25/100505.2.2.2.1Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs505.2.2.2.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom , 1 MHz bzw. 314 kA/µs545.2.2.3Berechnungen für Klasse 1, 100 kA, 1/200565.2.2.3.1Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs565.2.2.3.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs605.2.2.4Vergleich der Ergebnisse636LITERATUR657ANHANG657.1KOPPLUNG ZWISCHEN ABLEITUNG UND DER NÄHERUNGSLEITUNG STOßKENNLINIE FÜR TRENNUNGSANORDNUNG NACH ZISCHANK667.3ANALYTISCHE BERECHNUNG DES TRENNUNGSABSTANDS AUS DER STOßKENNLINIE.70	5.2.2 TRENNUNGSABSTANDSBERECHNUNG AN EINEM KOMPLEXEN GEBÄUDE MIT NÄHERUNG IN GROßEM ABS	STAND
5.2.2.1Modellgeometrie485.2.2.2Berechnung für Klasse 1 50 kA 0,25/100505.2.2.2.1Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, , Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs505.2.2.2.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom , 1 MHz bzw 314 kA/µs545.2.2.3Berechnungen für Klasse 1, 100 kA, 1/200565.2.2.3.1Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs565.2.2.3.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs605.2.2.4Vergleich der Ergebnisse636LITERATUR657ANHANG657.1KOPPLUNG ZWISCHEN ABLEITUNG UND DER NÄHERUNGSLEITUNG657.2STOßKENNLINIE FÜR TRENNUNGSANORDNUNG NACH ZISCHANK667.3ANALYTISCHE BERECHNUNG DES TRENNUNGSABSTANDS AUS DER STOßKENNLINIE.70	VON DER ABLEITUNG	48
5.2.2.2Berechnung für Klasse 1 50 kA 0,25/100505.2.2.2.1Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs505.2.2.2.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom , 1 MHz bzw 314 kA/µs545.2.2.3Berechnungen für Klasse 1, 100 kA, 1/200565.2.2.3.1Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs565.2.2.3.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs605.2.2.4Vergleich der Ergebnisse636LITERATUR657ANHANG657.1KOPPLUNG ZWISCHEN ABLEITUNG UND DER NÄHERUNGSLEITUNG657.2STOßKENNLINIE FÜR TRENNUNGSANORDNUNG NACH ZISCHANK667.3ANALYTISCHE BERECHNUNG DES TRENNUNGSABSTANDS AUS DER STOßKENNLINIE.70	5.2.2.1 Modellgeometrie	48
5.2.2.2.1Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, , Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/μs505.2.2.2.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom , 1 MHz bzw 314 kA/μs545.2.2.3Berechnungen für Klasse 1, 100 kA, 1/200565.2.2.3.1Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/μs565.2.2.3.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/μs605.2.2.4Vergleich der Ergebnisse636LITERATUR657ANHANG657.1KOPPLUNG ZWISCHEN ABLEITUNG UND DER NÄHERUNGSLEITUNG657.2STOßKENNLINIE FÜR TRENNUNGSANORDNUNG NACH ZISCHANK667.3ANALYTISCHE BERECHNUNG DES TRENNUNGSABSTANDS AUS DER STOßKENNLINIE.70	5.2.2.2 Berechnung für Klasse 1 50 kA 0,25/100	50
5.2.2.2.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom , 1 MHz bzw 314 kA/µs545.2.2.3Berechnungen für Klasse 1, 100 kA, 1/200565.2.2.3.1Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs565.2.2.3.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs605.2.2.4Vergleich der Ergebnisse636LITERATUR657ANHANG657.1KOPPLUNG ZWISCHEN ABLEITUNG UND DER NÄHERUNGSLEITUNG657.2STOBKENNLINIE FÜR TRENNUNGSANORDNUNG NACH ZISCHANK667.3ANALYTISCHE BERECHNUNG DES TRENNUNGSABSTANDS AUS DER STOßKENNLINIE.70	5.2.2.2.1 Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, , Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/μs	50
5.2.2.3Berechnungen für Klasse 1, 100 kA, 1/200565.2.2.3.1Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/μs565.2.2.3.2Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/μs605.2.2.4Vergleich der Ergebnisse636LITERATUR657ANHANG657.1KOPPLUNG ZWISCHEN ABLEITUNG UND DER NÄHERUNGSLEITUNG657.2STOBKENNLINIE FÜR TRENNUNGSANORDNUNG NACH ZISCHANK667.3ANALYTISCHE BERECHNUNG DES TRENNUNGSABSTANDS AUS DER STOßKENNLINIE.70	5.2.2.2.2 Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom , 1 MHz bzw 314 kA/μs	54
5.2.2.3.1       Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/μs       56         5.2.2.3.2       Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/μs       60         5.2.2.3.2       Vergleich der Ergebnisse       63         6       LITERATUR       65         7       ANHANG       65         7.1       KOPPLUNG ZWISCHEN ABLEITUNG UND DER NÄHERUNGSLEITUNG       65         7.2       STOBKENNLINIE FÜR TRENNUNGSANORDNUNG NACH ZISCHANK       66         7.3       ANALYTISCHE BERECHNUNG DES TRENNUNGSABSTANDS AUS DER STOßKENNLINIE.       70	5.2.2.3 Berechnungen für Klasse 1, 100 kA, 1/200	56
5.2.2.3.2       Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/μs       60         5.2.2.4       Vergleich der Ergebnisse       63         6       LITERATUR       65         7       ANHANG       65         7.1       KOPPLUNG ZWISCHEN ABLEITUNG UND DER NÄHERUNGSLEITUNG       65         7.2       STOßKENNLINIE FÜR TRENNUNGSANORDNUNG NACH ZISCHANK       66         7.3       ANALYTISCHE BERECHNUNG DES TRENNUNGSABSTANDS AUS DER STOßKENNLINIE.       70	5.2.2.3.1 Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/μs	56
5.2.2.4       Vergleich der Ergebnisse       63         6       LITERATUR       65         7       ANHANG       65         7.1       KOPPLUNG ZWISCHEN ABLEITUNG UND DER NÄHERUNGSLEITUNG       65         7.2       STOßKENNLINIE FÜR TRENNUNGSANORDNUNG NACH ZISCHANK       66         7.3       ANALYTISCHE BERECHNUNG DES TRENNUNGSABSTANDS AUS DER STOßKENNLINIE.       70	5.2.2.3.2 Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/μs	60
6LITERATUR657ANHANG657.1KOPPLUNG ZWISCHEN ABLEITUNG UND DER NÄHERUNGSLEITUNG657.2STOßKENNLINIE FÜR TRENNUNGSANORDNUNG NACH ZISCHANK667.3ANALYTISCHE BERECHNUNG DES TRENNUNGSABSTANDS AUS DER STOßKENNLINIE.70	5.2.2.4 Vergleich der Ergebnisse	63
7ANHANG657.1KOPPLUNG ZWISCHEN ABLEITUNG UND DER NÄHERUNGSLEITUNG657.2STOBKENNLINIE FÜR TRENNUNGSANORDNUNG NACH ZISCHANK667.3ANALYTISCHE BERECHNUNG DES TRENNUNGSABSTANDS AUS DER STOBKENNLINIE.70	<u>6</u> LITERATUR	65
7.1KOPPLUNG ZWISCHEN ABLEITUNG UND DER NÄHERUNGSLEITUNG657.2STOßKENNLINIE FÜR TRENNUNGSANORDNUNG NACH ZISCHANK667.3ANALYTISCHE BERECHNUNG DES TRENNUNGSABSTANDS AUS DER STOßKENNLINIE.70	7 ANHANG	65
7.2Stoßkennlinie für Trennungsanordnung nach Zischank667.3Analytische Berechnung des Trennungsabstands aus der Stoßkennlinie.70	7.1 KOPPLUNG ZWISCHEN ABLEITUNG UND DER NÄHERUNGSLEITUNG	65
7.3 ANALYTISCHE BERECHNUNG DES TRENNUNGSABSTANDS AUS DER STOßKENNLINIE. 70	7.2 STOBKENNLINIE FÜR TRENNUNGSANORDNUNG NACH ZISCHANK	66
	7.3 ANALYTISCHE BERECHNUNG DES TRENNUNGSABSTANDS AUS DER STOßKENNLINIE.	70

7.4Berechnung des Trennungsabstands aus den Ergebnnissen der induzierten Spannung UT mit<br/>GSA\_FD und der Stoßkennlinie.71

### 1 Ziel dieser Untersuchung

Nach der Veröffentlichung über die Berechnung der Schrittspannung mit GSA kam die Frage auf, wie die galvanische Kopplung im Erdsystem den notwendigen Trennungsabstand beeinflusst. Mit der neuen Version GSA\_FD 6.4.1 mit angepassten Impedanzwerten für Ableitungen und einer komfortablen Auswertemöglichkeit aller Spannungen und Ströme in einem komplexen äußeren Blitzschutzsystem lässt sich die Antwort auf die Frage finden.

### 2 Stand der Wissenschaft

Die neueren Veröffentlichungen von Zischank, Heilder zeigen deutliche Abweichungen der nach den IEC 62305-3 berechneten und den mit dem Programm "Concept" berechneten Trennungsabständen an Gebäuden **ohne Berücksichtigung des Erdsystems**. Die Berechnungen mit Concept sind nur für den negativen Folgestoßstrom durchgeführt worden.

Details in der Veröffentlichung:

NECESSARY SEPARATION DISTANCES FOR LIGHTNING PROTECTION SYSTEMS - IEC 62305-3 REVISITED Fridolin H. Heidler, Wolfgang J. Zischank Die folgende Grafik zeigt die Ergebnisse.



Fig. 13 - Comparison of the separation distances resulting from the CONCEPT computer code and from IEC 62305-3 (eq. <math>(3)) for the cases of corner strike and center strike to LPS type "a"

Eine Berechnung unter Berücksichtigung der Einflüsse des Erdsystems auf den Trennungsabstand ist bisher nicht veröffentlicht.

## 3 Normativer Bezug

IEC 62305-1, Protection against lightning – Part 1: General principles IEC 62305-3, Protection against lightning – Part 3: Physical damages to structures and life hazard

### 4 Berechnungsmethode GSA

GSA\_FD ist ein Programm zur Berechnung von Erdsystemen einschließlich des äußeren Blitzschutzsystems, also Fangeinrichtung und Ableitungen. Das Programm arbeitet im Frequenzbereich. Einzelheiten zur richtigen Nachbildung von Stoßströmen nach IEC 62305-1 (Heidlerimpulse) sind im Vortrag von Meppelink in Neu Ulm 2015 zusammengestellt, siehe Literatur. Die Stromsteilheit ist beim Heidlerimpuls immer 40 % größer als bei dem für die Klasse hinterlegten Wert in der Trennungsabstandsberechnung.

Beispiel: Klasse 1: di/dt=200kA/µs für Trennungsabstandsberechnung nach IEC 62305-3. In IEC 62305-1 wird aber für Berechnungen der Heidlerimpuls für Klasse mit einem di/dt von 280 kA/µs angegeben. Das bleibt einer der Widersprüche in der Normenreihe IEC 62305.

Das Programm GSA arbeitet mit sinusförmigen Strömen. Dabei kann der Scheitelwert richtig nachgebildet werde, die Stromsteilheit ist dabei jedoch 11 % größer gegenüber dem Heidlerimpuls, siehe Tabelle 4-1.

Eine Berücksichtigung des km-Koeffizienten ist in dieser Berechnung nicht vorgesehen. Alle Berechnungen werden für Luftisolierte Anordnungen durchgeführt. Die Berücksichtigung von Baustoffen führt dann zu einer Vergrößerung des Trennungsabstands

Die Bestimmung des erforderlichen Trennungsabstands erfolgt nach der Stoßkennlinie in Bild 7-3.

Der Ablauf einer Berechnung mit GSA\_FD ist in Tabelle 4-3 dargestellt.

Tabelle 4-1 Vergleich der Stromsteilheiten, Heidlerimpuls 0,25/100 nach IEC 62305-1 und Sinusschwingung 1 MHz



Tabelle 4-2 Vergleich der möglichen Nachbildung der genormten Stoßstromparameter durch eine Sinusschwingung.

	bildung-	g- Sinus-Nachbildung			
Stoßstromform	di/dt nach IEC 62305-1	di/dt Heidlerimpuls	Frequenz	di/dt <sub>t=0</sub>	Güte der Nachbildung
	kA/µs	kA/μs	MHz	kA/μs	
0,25/100 50 kA	200	280	1	314	Korrekte Frequenz di/dt 11 % zu groß
1/200 100 kA	100	140	0,25	157	Heidlerimpuls

#### Tabelle 4-3 Ablauf einer Berechnung des Trennungsabstands mit GSA\_FD



## **5 Untersuchte Geometrien**

Die untersuchten Anordnungen zeigt Tabelle 5-1.

Tabelle 5-1 Übersicht der untersuchten Anordnungen

Einfache Anordnung	Komplexe Anordnung nach IEC 62305-3	Komplexe Anordnung mit großflächiger
nach IEC 62305-3	Hintergrund	Näherung
Hintergrund	_	
Berechnung mit	Berechnung mit 0,25/100, Klasse 1	Berechnung mit 0,25/100
0,25/100 Klasse 1		und 1/200, Klasse 1
Relevante	Relevante Ableitungslänge für	Relevante Ableitungslänge für
Ableitungslänge für	Trennungsabstandsberechnung : 9,25m	Trennungsabstandsberechnung : 9,25m
Trennungsabstands-		
berechnung :9,25m		
Erdungsgitter 6m*6m	Gebäude: 45	5m*15m*10m
mit Maschenweite	Erdungsgitter 1,5m*	1,5m in 0,25 m Tiefe
0,5m. Tiefe : 1 m.		
Trennungsabstand im	Trennungsabstand im Berechnungsmodell	Trennungsabstand im Berechnungsmodell
Berechnungsmodell	eingestellt auf : 2,11m	eingestellt auf : 2,11m
eingestellt auf : 1m		

### 5.1 Überprüfung der IEC-62305-3- Methode zur Trennungsabstandsberechnung an einer einzelnen Ableitung

#### 5.1.1 Grundlage der IEC-62305-3- Berechnung



#### Legende

- 1 metallener Heizkörper
- 2 Wand aus Ziegeln oder Holz
- 3 Heizkessel
- 4 Potentialausgleichsschiene
- 5 Erdungsanlage
- 6 Verbindung mit der Erdungsanlage oder der Ableitung
- 7 ungünstigster Blitzeinschlagspunkt
- d tatsächlicher Abstand
- 1 Länge für die Berechnung des Trennungsabstandes s

ANMERKUNG Die bauliche Anlage besteht aus isolierenden Ziegeln.

Bild E.47 – Hinweise zur Berechnung des Trennungsabstands s für den ungünstigsten Einschlagspunkt im Abstand / vom Potentialausgleichspunkt nach 6.3

Bild 5-1 Erklärung zur Berechnung des Trennungsabstands. Hinweis: In IEC 62305-3 wird in der Berechnung der Trennungsabstand mit s angegeben.

Die Berechnung der Gegeninduktivität einer Ableitung für die Annahmen, die in der IEC 62305-3 gemacht wurden, ergibt folgendes Ergebnis:

Nach Aussagen von Kransteiner wurde der Wert willkürlich auf M´=1,2 $\mu$ H/m festgelegt. Es ist nun festzustellen, für welches Verhältnis r<sub>a</sub>/r<sub>i</sub> dieser Wert gilt.

$$M' = \frac{1,256\mu H}{2\pi} \cdot \ln \frac{r_a}{r_i}$$
 Gleichung 5-1

Mit  $r_a=2m$  und  $r_i=5mm$  ergibt sich ein Wert für M' von 1,2µH/m wie in der IEC 62305-3 in der Formel für den Trennungsabstand s hinterlegt ist.

Das bedeutet:

Nach der IEC 62305-3 wird bei der Berechnung des Trennungsabstands immer eine Fläche im Abstand von 2 m von der Ableitung bis zur Höhe (Länge I in Bild 5-1) der betrachteten Trennstelle zugrunde gelegt.

In der Realität trifft dies aber nicht zu. Die Potentialausgleichsschiene bzw. Verbindung mit der Erdungsanlage oder der Ableitung kann weit entfernt vom Ort des Einschlags sein.

Der Hintergrund der Trennungsabstandsberechnung ist in einer separaten Datei wiedergegeben, siehe Literaturangabe (Meppelink).

#### 5.1.2 Berechnung mit GSA\_FD Version 6.4.1

Das Programm arbeitet im Frequenzbereich. Details sind im Vortrag Meppelink VDE-ABB Neu Ulm 2015 beschrieben, Meppelink VDE-ABB 2015 .

Für den negativen Folgeblitz wird der in IEC 62305-1 definierte Heidlerimpuls mit einer äquivalenten Frequenz von 1 MHz nachgebildet. Der Scheitelwert wird durch die Sinusfunktion richtig wiedergegeben. Die maximale Steilheit der Sinusfunktion di/dt<sub>(max,Sinus)</sub> ist jedoch gegenüber der maximalen Steilheit der Heidlerfunktion di/dt<sub>(max,Heidler)</sub> um etwa 11 % größer.

Hinweis: Die Trennungsabstandsberechnung nach IEC 62305-3 rechnet nicht mit dem Heidler-Impuls, sondern mit der Rampenfunktion nach Zischank.

Der Berechnungsablauf ist in Tabelle 4-3 dargestellt. Die Bestimmung des erforderlichen Trennungsabstands erfolgt nach der Stoßkennlinie in Bild 7-3.

#### 5.1.3 Kontrolle des GSA\_FD-Programms

#### 5.1.3.1 Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung oberhalb der Erde

Ein einfaches Modell ist in Bild 5-2 bis Bild 5-8 gezeigt. Eine Fangstange ist symmetrisch in der Mitte angeordnet. Eine Näherung ist in einem Abstand von 2 m von der Ableitung angeordnet und weist eine Länge von 9,25 m auf, ausgehend vom Anschluss an das Erdungsgitter bis zum Ort , an dem der Trennungsabstand berechnet werden soll.

Der Trennungsabstand nach IEC 62305-3 errechnet sich für Klasse 1 zu

$$s = \frac{k_i \cdot k_c}{k_m} \cdot 1 = \frac{0.08 \cdot 1}{1} \cdot 9,25m = 0,74m \qquad \text{Gleichung 5-2}$$

Dabei ist im Hintergrund der IEC 62305-3 eine Steilheit di/dt<sub>(max)</sub> von 200 kA/µs für Klasse 1 berücksichtigt.

Mit dem Ziel, die in IEC 62305-3 angegebene Methode richtig wiederzugeben, wird bewusst eine Näherung erzeugt, deren Leitung in einem Abstand von 2 m von der Ableitung verläuft.

Damit kann also das Verfahren in IEC 62305-3 überprüft werden, die Ergebnisse zeigt Tabelle 5-2.

Die Ergebnisse zeigen eine gute Übereinstimmung der analytisch berechneten induzierten Spannung und der vom Programm GSA\_FD berechneten induzierten Spannung.

Nach der IEC Berechnung nach Gleichung 4-1 ergibt sich ein Trennungsabstand von 0,78 m, der auch normativ gültig ist. Nach der In IEC 62305-1 angegebenen analytischen Stoßstromform (Heidlerfunktion) für Berechnungen ergibt sich der Trennungsabstand zu 0,81 m.

Tabelle 5-2	Ergebnisse de	r Simulation	für 0,25/100	entsprechend	1 MHz. 50	kA, Klasse 1	
							-

			Re	Im	Betrag,rms	Peak	
		Ableitung	1.008.875	4.575.807	4.685.706	6.626.589	V
		Näherung	993.380	2.073.167	2.298.875	3.251.100	V
		UT	15.495	2.502.640	2.502.688	3.539.335	V
Analytische Berechnu	ing Mdi/dt*l=1	,2*1*314*9,25*1	000 für Sinust	form		3.480.442	V
Trennungsabstand au	us analytische	er Berechnung fü	r Sinusform m	it 314 kA/µs			
und Stoßkennlinie						0,80	m
Analytische Berechnu	ing Mdi/dt*l=1	,2*1*280*9,25*1	000 für die St	eilheit des			
Heidlerimpulses						3.103.578	V
Trennungsabstand au	us analytische	er Berechnung fü	r die Steilheit	des			
Heidlerimpulses mit 2	80 kA/µs und	Stoßkennlinie				0,78	m
Analytische Berechnu	ing Mdi/dt*l=1	,2*1*200*9,25*1	000			2.220.000	V
Trennungsabstand au	us analytische	er Berechnung m	it 200 kA/µs u	nd			
Stoßkennlinie	-	-	-			0,74	m
Trennungsabstand aus IEC 62305-3 mit kc=1, I=9,25m							m
Trennungsabstand aus GSA Berechnung						0,81	m
Spannungsdifferenz l	J⊤ - Mdi/dt					58.894	V

Der relative Fehler gegenüber der analytischen Berechnung beträgt 1,7 %.



Bild 5-2 3-D-Ansicht der Anordnung entsprechend dem Hintergrund der Berechnung nach IEC 62305-3 mit M´=1,2µH/m bei einem Abstand von 2 m zwischen Ableitung und Näherung. Durchmesser der Ableitung und der Näherung: 10mm Kupfer. Länge der Näherung : 9,25m in Luft.



Bild 5-3 Detailansicht der Anordnung entsprechend dem Hintergrund der Berechnung nach IEC 62305-3 mit M´=1,2µH/m bei einem Abstand von 2 m zwischen Ableitung und Näherung. Durchmesser der Ableitung und der Näherung: 10mm Kupfer. Länge der Näherung : 9,25m in Luft.



Bild 5-4 2-D-Ansicht der Anordnung entsprechend dem Hintergrund der Berechnung nach IEC 62305-3 mit M'=1,2µH/m bei einem Abstand von 2 m zwischen Ableitung und Näherung. Durchmesser der Ableitung und der Näherung: 10mm Kupfer. Länge der Näherung : 9,25m in Luft. Die Näherung endet in einer Höhe von 10,25m.



Bild 5-5 Erdoberflächenpotential in 3 D Darstellung. Berechnung für  $\rho_E$  = 100 Ohmm und 50 kA 0,25/100 mit einer Frequenz von 1 MHz.



Bild 5-6 Potentialverlauf entlang der Ableitung bis zu einer Höhe von 10,25 m oberhalb Erdoberfläche. Gesamtlänge der Ableitung: 10,25 m. Berechnung für  $\rho_E$  = 100 Ohmm und 50 kA 0,25/100 mit einer Frequenz von 1 MHz.

#### Version 01/12/2015



Bild 5-7 Potentialverlauf entlang der Näherung ausgehend von einer Höhe von 1 m bis zu einer Höhe von 10,25 m oberhalb Erdoberfläche. Gesamtlänge der Ableitung: 9,25 m. Berechnung für  $\rho_E$  = 100 Ohmm und 50 kA 0,25/100 mit einer Frequenz von 1 MHz.



Bild 5-8 Stromverlauf entlang der Näherung ausgehend von einer Höhe von 10,25 m bis zu einer Höhe von 1 m oberhalb Erdoberfläche. Gesamtlänge der Ableitung: 9,25 m. Berechnung für  $\rho_E$  = 100 Ohmm und 50 kA 0,25/100 mit einer Frequenz von 1 MHz.

#### 5.1.3.2 Eine Ableitung mit einem Tiefenerder und Potentialanschluss der Näherung 0,25 m unterhalb der Erde

Die Anordnung entspricht der im vorigen Abschnitt. Nur der Anschluss der Näherung befindet sich gemäß Bild 5-9 0,25 m im Erdreich. Dadurch kommt es zum Stromabfluss über den im Erdreich liegenden Teil der Näherung und damit zu einer magnetischen Einkopplung dieses Erdstroms in die Näherungsschleife.

Das Erdoberflächenpotential in Bild 5-10 und Bild 5-11 zeigt erwartungsgemäß einen anderen Verlauf gegenüber dem Fall mit einer Näherung oberhalb der Erdoberfläche. Die Potentialverläufe zeigen Bild 5-12 und Bild 5-13.Die Ergebnisse zeigt Tabelle 5-3. Der Strom auf dem horizontal in der Erde verlaufenden Teil der Näherung ist in Bild 5-14 dargestellt. Ein nennenswerter Anteil fließt über diesen Teil der Näherun ab und erzeugt in der Näherungsschleife ein zusätzliches Magnetfeld. Dies führt zu einer Erhöhung der Spannung gegenüber analytisch berechneten Spannung für eine stromlose Näherung. Auf dem vertikalen Teil der Näherung kommt es zu einem kapazitiv eingekoppelten Stromanteil, siehe Bild 5-15.

Bedingt durch die magnetische Einkopplung ist die berechnete Spannung  $U_T$  etwas größer als die analytische Berechnung. Die Änderung liegt im 5 % Bereich.

		Re	Im	Betrag,rms	Peak	
	Ableitung	855.217	3902253	3.994.869	5.649.597	V
	Näherung	877.724	1.312.019	1.578.542	2.232.395	V
	UT	-22.507	2.590.234	2.590.332	3.663.282	V
Analytische Berechnu	ing Mdi/dt*l=1	,2*1*314*9,25	*1000 für Sinusform		3.480.442	V
Trennungsabstand au	is analytische	er Berechnung	für Sinusform mit 314 kA/µs			
und Stoßkennlinie					0,80	m
Analytische Berechnu	ing Mdi/dt*l=1	,2*1*280*9,25 <sup>°</sup>	*1000 für die Steilheit des			
Heidlerimpulses					3.103.578	V
Trennungsabstand au	is analytische	er Berechnung	für die Steilheit des			
Heidlerimpulses mit 2	80 kA/µs und	Stoßkennlinie			0,78	m
Analytische Berechnu	ing Mdi/dt*l=1	,2*1*200*9,25 <sup>*</sup>	*1000		2.220.000	V
Trennungsabstand au	is analytische	er Berechnung	mit 200 kA/µs und			
Stoßkennlinie					0,74	m
Trennungsabstand aus IEC 62305-3 mit kc=1, I=9,25m					0,74	m
Trennungsabstand aus GSA Berechnung					0,84	m
Spannungsdifferenz L	J⊤ - Mdi/dt				182.841	V

Tabelle 5-3 Ergebnisse der Simulation für 0,25/100 entsprechend 1 MHz. 50 kA, Klasse 1.

Die relative Änderung gegenüber der analytischen Berechnung beträgt 5,2 %.



Bild 5-9 Darstellung der Näherung, die 0,25 m im Erdreich verläuft.

#### Version 01/12/2015



Bild 5-10 Erdoberflächenpotential in 3 D Darstellung. Berechnung für  $\rho_E$  = 100 Ohmm und 50 kA 0,25/100 mit einer Frequenz von 1 MHz.



Bild 5-11 Erdoberflächenpotential entlang der Näherung. Berechnung für  $\rho_E$  = 100 Ohmm und 50 kA 0,25/100 mit einer Frequenz von 1 MHz.

#### Version 01/12/2015



Bild 5-12 Potentialverlauf entlang der Ableitung bis zu einer Höhe von 9 m oberhalb Erdoberfläche. Gesamtlänge der Ableitung: 9,25 m. Berechnung für  $\rho_E$  = 100 Ohmm und 50 kA 0,25/100 mit einer Frequenz von 1 MHz.



Bild 5-13 Potentialverlauf entlang der Näherung ausgehend von einer Höhe von 0,25 m in der Erde bis zu einer Höhe von 9 m oberhalb Erdoberfläche. Gesamtlänge der Ableitung: 9,25 m. Berechnung für  $\rho_E$  = 100 Ohmm und 50 kA 0,25/100 mit einer Frequenz von 1 MHz.



Bild 5-14 Stromverlauf auf dem horizontalen Teil der Näherung in 0,25 m Tiefe. Berechnung für  $\rho_E$  = 100 Ohmm und 50 kA 0,25/100 mit einer Frequenz von 1 MHz.



Bild 5-15 Stromverlauf auf dem vertikalen Teil der Näherung ausgehend von 0,25 m Tiefe bis zu einer Höhe von 9m. Berechnung für  $\rho_E$  = 100 Ohmm und 50 kA 0,25/100 mit einer Frequenz von 1 MHz.

#### 5.1.3.3 Ergebnisvergleich

Das einfache Beispiel hat die Richtigkeit der Berechnung mit GSA\_FD gezeigt.

Tabelle 5-4 Ergebnisvergleich

	Näherung 1m oberhalb Erde	Näherung 0,25m in der Erde
Ableitung	6.626.589	5.649.597
Näherung	3.251.100	2.232.395
Aus GSA_FD: U <sub>T</sub>	3.539.335	3.663.282
Berechneter Trennungsabstand mit GSA_FD	0,81m	0,84m
Analytisch Ua	3.48	30.442

#### 5.1.4 Eine Ableitung mit einem Erdungsgitter und Potentialanschluss der Näherung unterhalb der Erde

Ein einfaches Modell ist in Bild 5-16, Bild 5-17 und Bild 5-18 gezeigt. Eine Fangstange ist symmetrisch in der Mitte über einem Erdungsgitter angeordnet. Eine Leitung ist in einem Abstand von 2 m von der Ableitung angeordnet und weist eine Länge von 12,5 m auf, ausgehend vom Anschluss an das Erdungsgitter bis zum Ort, an dem der Trennungsabstand berechnet werden soll.

Der Trennungsabstand nach IEC 62305-3 errechnet sich für Klasse 1 zu:

$$s = \frac{k_i \cdot k_c}{k_m} \cdot 1 = \frac{0.08 \cdot 1}{1} \cdot 9,25m = 0,74m$$
 Gleichung 5-3

Dabei ist im Hintergrund der IEC 62305-3 eine Steilheit di/dt<sub>(max)</sub> von 200 kA/µs für Klasse 1 berücksichtigt.

Mit dem Ziel, die in IEC 62305-3 angegebene Methode richtig wiederzugeben, wird bewusst eine Näherung erzeugt, deren Leitung in einem Abstand von 2 m von der Ableitung verläuft und an der betrachteten Stelle einen Abstand von 1 m entsprechend des berechneten Trennungsabstands aufweist.

Damit kann also das Verfahren in IEC 62305-3 überprüft werden.



Bild 5-16 Anordnung entsprechend dem Hintergrund der Berechnung nach IEC 62305-3 mit M'=1,2µH/m bei einem Abstand von 2 m zwischen Ableitung und Näherung. Durchmesser der Ableitung und der Näherung: 10mm Kupfer. Länge der Näherung : 9m in Luft und 0,25 m in der Erde.



Bild 5-17 Detailansicht der Anordnung in Bild 5-16 entsprechend dem Hintergrund der Berechnung nach IEC 62305-3 mit M´=1,2µH/m bei einem Abstand von 2 m zwischen Ableitung und Näherung. Durchmesser der Ableitung und der Näherung: 10mm Kupfer.

#### Version 01/12/2015



Bild 5-18 Wie Bild 5-16 jedoch isometrische Darstellung.

#### 5.1.4.1 Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314 kA/µs

Das Erdoberflächenpotential in Bild 5-19 zeigt im Bereich der Näherung einen gleichmäßigen Verlauf. Der Abfall ist nicht so steil wie bei anderen Anordnungen, die in Neu Ulm vorgestellt wurden. Das liegt an dem kleinen Erdungsgitter und der mittigen Stromeinspeisung.

Zum weitern Verständnis ist in Bild 5-20 der Verlauf des Erdoberflächenpotentials entlang der Mittellinie der Anordnung dargestellt. Hier zeigt sich, wie bereits in der 3 D Darstellung in Bild 5-19 der moderate Verlauf des Erdoberflächenpotentials.

Mit dem Programm GSA\_FD lassen sich jetzt die Potentialverläufe einzelner Leiter darstellen. Dabei sind Betrag, Realteil und Imaginärteil einzeln abzulesen. Die Verläufe sind in Bild 5-21 und Bild 5-22 dargestellt. Die Spannung U<sub>T</sub> an der Näherung, vergl. Bild 5-17 ergibt sich dann unter Berücksichtigung von Real-und Imaginärteil aus der Differenz der Potentiale an den entsprechenden Stellen.

Die Näherung ist nicht stromlos. Durch kapazitive Kopplung zwischen der Ableitung und der Näherung entsteht auf der Näherung ein Strom gemäß Bild 5-23.

Die Ergebnisse der Simulation im Vergleich zu analytischen Berechnungen zeigt Tabelle 5-5

Der Trennungsabstand aus der GSA\_FD Berechnung stimmt exakt mit der analytischen Trennungsabstandsberechnung überein. Aus der analytischen Berechnung der induzierten Spannung und der berechneten Spannung U<sub>T</sub> an der Trennstelle ergibt sich eine Differenz von 244 kV, die auf die Kopplung zwischen Ableitung und Näherung zurückzuführen ist. Tabelle 5-5 Ergebnisse der Simulation mit 1 MHz

		Re	Im	Betrag,rms	Peak	
	Ableitung	386.429	3.630.194	3.650.703	5.162.874	V
	Näherung	369.556	1.060.114	1.122.681	1.587.711	V
	UT	16.873	2.570.080	2.570.135	3.634.720	V
Analytische	000	3.480.442	V			
Trennungs	abstand aus	analytischer Be	rechnung mit	t di/dt=314kA/µs und		
Stoßkennli	nie für 314 k/	∿/µs Ud=4.368.0	)00V/m, sieh	e Abschnitt 7.2	0,80	m
Analytische	e Berechnung	g Mdi/dt*l=1,2*1	*200*9,25*10	000	2.220.000	V
Trennungs	abstand aus	analytischer Be	rechnung mit	t di/dt=200kA/µs und		
Stoßkennli	nie für 200kA	/µs Ud=3.000.0	00V/m, siehe	e Abschnitt 7.2	0,74	m
Trennungs	abstand aus	IEC 62305-3 mi	t kc=1, l=9,2	5m	0,74	m
Trennungs	0,83	m				
Spannungs	154.279	V				
Abweichun	g U⊤ gegen a	analytische Bere	chnung :		4,4	%



Bild 5-19 Erdoberflächenpotential in 3 D Darstellung. Berechnung für  $\rho_E$  = 100 Ohmm und 50 kA 0,25/100 mit einer Frequenz von 1 MHz.



Bild 5-20 Verlauf des Erdoberflächenpotentials auf der im Bild dargestellten gestrichelten Linie. Berechnung für  $\rho_{E}$  = 100 Ohmm und 50 kA 0,25/100 mit einer Frequenz von 1 MHz.



Bild 5-21 Potentialverlauf entlang der Ableitung ausgehend vom Erdungsgitter in 0,25 m Tiefe bis zu einer Höhe von 9 m oberhalb Erdoberfläche. Gesamtlänge der Ableitung: 9,25 m. Berechnung für  $\rho_E$  = 100 Ohmm und 50 kA 0,25/100 mit einer Frequenz von 1 MHz.



Bild 5-22 Potentialverlauf entlang der Näherung ausgehend vom Erdungsgitter in 0,25 m Tiefe bis zu einer Höhe von 9 m oberhalb Erdoberfläche und dem 1 m langen Knick, vergl. Bild 5-17. Gesamtlänge der Näherung nach den Definitionen in IEC 62305-3: 9,25 m. Berechnung für  $\rho_{\rm E}$  = 100 Ohmm und 50 kA 0,25/100 mit einer Frequenz von 1 MHz.



Bild 5-23 Stromverlauf entlang der Näherung ausgehend vom Erdungsgitter in 0,25 m Tiefe bis zu einer Höhe von 9 m oberhalb Erdoberfläche und dem 1 m langen Knick, vergl. Bild 5-17. Berechnung für  $\rho_E$  = 100 Ohmm und 50 kA 0,25/100 mit einer Frequenz von 1 MHz.

#### 5.1.4.2 Berechnung für Klasse 1, 100 kA 1/200, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs

Das Erdoberflächenpotential in Bild 5-24 zeigt einen gleichmäßigen Verlauf. Der Abfall ist nicht so steil wie bei anderen Anordnungen, die in Neu Ulm vorgestellt wurden. Das liegt an dem kleinen Erdungsgitter und der mittigen Stromeinspeisung.

Zum weitern Verständnis ist in Bild 5-25 der Verlauf des Erdoberflächenpotentials entlang der Mittellinie der Anordnung dargestellt. Hier zeigt sich, wie bereits in der 3 D Darstellung in Bild 5-24 der moderate Verlauf des Erdoberflächenpotentials.

Mit dem Programm GSA\_FD lassen sich jetzt die Potentialverläufe einzelner Leiter darstellen. Dabei sind Betrag, Realteil und Imaginärteil einzeln abzulesen. Die Verläufe sind in Bild 5-26 und Bild 5-27 dargestellt. Die Spannung  $U_T$  an der Näherung, vergl. Bild 5-17 ergibt sich dann unter Berücksichtigung von Real-und Imaginärteil aus der Differenz der Potentiale an den entsprechenden Stellen.

Die Näherung ist nicht stromlos. Durch kapazitive Kopplung zwischen der Ableitung und der Näherung entsteht auf der Näherung ein Strom gemäß Bild 5-28.

Die Ergebnisse der Simulation im Vergleich zu analytischen Berechnungen zeigt Tabelle 5-6

Der Trennungsabstand aus der GSA\_FD Berechnung stimmt bis auf 1 % mit der analytischen Trennungsabstandsberechnung überein.

# Der Trennungsabstand ist aber bei dem 1/200-Impuls (Simuliert mit 0,25 MHz) mit 1,12 m deutlich größer als bei der nach IEC 62305-3 zugrunde gelegten Stoßstromform 0,25/100.

		Re	lm	Betrag,rms	Peak	
	Ableitung	474.617	1.711.916	1.776.490	2.504.851	V
	Näherung	478.186	487.178	682.645	962.530	V
	UT	-3.569	1.224.738	1.224.743	1.726.888	V
Analytische	e Berechnung	g Mdi/dt*l=1,2*1	*157*9,25*10	000	1.742.700	V
Trennungs	abstand aus	analytischer Be	rechnung		1,13	m
Trennungsabstand aus GSA Berechnung						m
Spannungsdifferenz U <sub>T</sub> - M*di/dt*l					-15.812	V
Abweichung U $_{T}$ gegen analytische Berechnung :						%

Tabelle 5-6 Ergebnisse der Simulation mit 0,25 MHz



Bild 5-24 Erdoberflächenpotential in 3 D Darstellung. Berechnung für  $\rho_{E}$  = 100 Ohmm und 100 kA 1/200 mit einer Frequenz von 0,25 MHz.



Bild 5-25 Verlauf des Erdoberflächenpotentials auf der im Bild dargestellten gestrichelten Linie. Berechnung für  $\rho_{E}$  = 100 Ohmm und 100 kA 1/200 mit einer Frequenz von 0,25 MHz.



Bild 5-26 Potentialverlauf entlang der Ableitung ausgehend vom Erdungsgitter in 0,25 m Tiefe bis zu einer Höhe von 9 m oberhalb Erdoberfläche. Gesamtlänge der Ableitung: 9,25 m. Berechnung für  $\rho_E$  = 100 Ohmm und 100 kA 1/200 mit einer Frequenz von 0,25 MHz.



Bild 5-27 Potentialverlauf entlang der Näherung ausgehend vom Erdungsgitter in 0,25 m Tiefe bis zu einer Höhe von 9 m oberhalb Erdoberfläche und dem 1 m langen Knick, vergl. Bild 5-17. Gesamtlänge der Näherung nach den Definitionen in IEC 62305-3: 9,25 m. Berechnung für  $\rho_{\rm E}$  = 100 Ohmm und 100 kA 1/200 mit einer Frequenz von 0,25 MHz.



Bild 5-28 Stromverlauf entlang der Näherung ausgehend vom Erdungsgitter in 0,25 m Tiefe bis zu einer Höhe von 9 m oberhalb Erdoberfläche und dem 1 m langen Knick, vergl. Bild 5-17. Berechnung für  $\rho_E$  = 100 Ohmm und 100 kA 1/200 mit einer Frequenz von 0,25 MHz.

#### 5.1.5 Vergleich der Ergebnisse

Die Ergebnisse sind in Tabelle 5-7 zusammengestellt und zeigen, dass die Simulation mit der Frequenz von 1 MHz bzw. 0,25 MHz die richtigen Ergebnisse zeigen.

Dia Abweichung gegenüber den Frequenzen 0,637MHz und 0,159 MHz ist im Bereich von 10-20 %

Die Ergebnisse sind in der Grafik in Bild 5-29 dargestellt.

Tabelle 5-7 Vergleich der Ergebnisse aller Simulationen und analytischer Berechnung. Alle Werte gelten für spezifischen Bodenwiderstand von 100 OHmm.

	di/dt	M*	Spannung an Trennstelle	Trennungs- abstand
			UT	S <sup>1)</sup>
	kA/μs	μH/m	kV	m
	0,25/100			
IEC Methode (Zischank) Rampenmethode 200kA/µs	200	1,2	2m*9,25m= 18,5m <sup>2</sup>	2217 0,74
GSA-Simulation mit 314kA/µs f=1 MHz	314		3634	0,83
Analytische Berechnung	314	Mdi/dt	3480	0,8
Analytische Berechnung	200	Mdi/dt	2220	0,74
Spannungsdifferenz (U <sub>T</sub> - Mdi/dt) durch galvanisc Kopplung	che kapazitive un	nd magnetische	154 F= 4,4 %	
	1/200			
GSA-Simulation mit 157kA/μs f= 0,25 MHz	157		1726	1,12
Analytische Berechnung	157	Mdi/dt	1742	1,13
Analytische Berechnung	1108	0,84		
Spannungsdifferenz (U⊤ - Mdi/dt) durch galvanisc Kopplung	-15,8 F=-0,9%			

1) Für die Spannungsfestigkeit siehe Stoßkennlinie Abschnitt 7.2.



Bild 5-29 Darstellung der ermittelten Trennungsabstände

### 5.2 Trennungsabstandsberechnung an einem komplexen Gebäude

Ausgehend von dem im Vortrag in Neu ULM 2015 vorgestellten Gebäude (Meppelink VDE-ABB 2015 Vortrag Neu Ulm) werden die Trennungsabstände für verschiedene Näherungssituationen untersucht. Dabei werden folgende Aspekte berücksichtigt:

- Anschlussstelle einer Näherung, nah oder fern des Einschlagspunktes
- Spezifischer Bodenwiderstand
- Impulsform 0,25/100 und 1/200 jeweils Klasse 1

#### 5.2.1 Berechnung mit Geometrie nach Hintergrund der IEC 62305-3

#### 5.2.1.1 Modellgeometrie

Das untersuchte Gebäude mit den Abmessungen 45m\*15m\*10m zeigt Bild 5-30 und Bild 5-32 Es steht auf einem Maschengitter mit der Maschenweite 1,5m x 1,5m. Das Maschengitter ist in 0,25m Tiefe angeordnet. Eine Näherung ist gemäß Bild 5-31 in einem Abstand von 2,12 m angeordnet. Dieser Abstand ergibt sich praktischerweise durch das vorhandene Erdungsgitter. Der Abstand oben an der Trennstelle ist auf 0,36 m eingestellt.

Der nach IEC 62305-3 berechnete Trennungsabstand für Klasse 1 beträgt 0,36m.

$$s = \frac{0,08 \cdot 0,44}{1} \cdot 9,25m = 0,36m$$
 Gleichung 5-4

Zur Kontrolle: Die Gegeninduktivität beträgt:

$$M' = \frac{1,256\mu H / m}{2\pi} \cdot ln \frac{2,115}{0,005} = 1,2\mu H / m \qquad \text{Gleichung 5-5}$$

Damit entspricht diese Anordnung der Grundlage der IEC -Trennungsabstandsberechnung nach 62305-3.



Bild 5-30 Anordnung entsprechend dem Hintergrund der Berechnung nach IEC 62305-3 mit M'=1,2µH/m bei einem Abstand von 2,12 m zwischen Ableitung und Näherung. Durchmesser der Ableitung und der Näherung: 10mm Kupfer. Gebäude: 45m\*15m\*10m.



9,25 m= Länge vom 0,25 m tiefen Erdungsgitter bis zum Ende der Näherung in 9 m Höhe = der Länge I zur Berechnung des Trennungsabstands.

Bild 5-31 Detailansicht der Anordnung in Bild 5-30 nach dem Hintergrund der Berechnung nach IEC 62305-3 mit M´=1,2µH/m bei einem Abstand von 2,12 m zwischen Ableitung und Näherung. Durchmesser der Ableitung und der Näherung: 10mm Kupfer. Länge I :9,25 m Trennungsabstand nach IEC 62305-3: 36 cm.



Bild 5-32 Wie Bild 5-30, jedoch isometrische Darstellung.

#### 5.2.1.2 Berechnung für Klasse 1, 50 kA 0,25/100

#### 5.2.1.2.1 Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314kA/µs

Das Erdoberflächenpotential in Bild 5-33 und Bild 5-34 zeigt einen **stark asymmetrischen Verlauf**. Das liegt an dem räumlich mehr ausgedehnten Erdungsgitter und der Stromeinspeisung an dessen Kante.

Zum weitern Verständnis ist in Bild 5-36 der Verlauf des Erdoberflächenpotentials entlang der gestrichelten Linie dargestellt. Hier zeigt sich, wie bereits in der 3 D Darstellung in Bild 5-34, der Abfall des Erdoberflächenpotentials im Bereich der Näherung. Es fällt auf, dass der Abfall hier relativ gering ist. Erst bei größeren Abständen von der Ableitung fällt das Erdoberflächenpotential steiler ab.

Die Stromaufteilung auf einzelne Ableitungen lässt sich anhand des Magnetfeldes gut visualisieren, siehe Bild 5-35.

Mit dem Programm GSA\_FD lassen sich jetzt die Potentialverläufe einzelner Leiter darstellen. Dabei sind Betrag, Realteil und Imaginärteil einzeln abzulesen. Die Verläufe sind in Bild 5-37 und Bild 5-38 dargestellt. Die Spannung U<sub>T</sub> an der Näherung ergibt sich dann unter Berücksichtigung von Real- und Imaginärteil aus der Differenz der Potentiale an den entsprechenden Stellen.

Die Näherung ist nicht stromlos. Durch kapazitive Kopplung zwischen der Ableitung und der Näherung entsteht auf der Näherung ein Strom gemäß Bild 5-39.

Die Ergebnisse der Simulation im Vergleich zu analytischen Berechnungen zeigt Tabelle 5-8

Der Trennungsabstand aus der GSA\_FD Berechnung stimmt exakt bis auf 10 % mit der analytischen Trennungsabstandsberechnung überein.

Der Trennungsabstand ist aber bei dem 0,25/100-Impuls (Simuliert mit 1 MHz) mit 49 cm etwa 20 % größer als bei der nach IEC 62305-3 zugrunde gelegten Stoßstromform 0,25/100. Hierbei ist zu beachten, dass auch von den beiden horizontalen Ableitungen an der Einschlagstelle ein gewisses Magnetfeld in die Näherung einkoppelt und ebenfalls eine Kopplung zur Näherung besteht.

Aus der analytischen Berechnung der induzierten Spannung und der berechneten Spannung U<sub>T</sub> an der Trennstelle ergibt sich eine Differenz von 312 kV, die auf die Kopplung zwischen Ableitung und Näherung zurückzuführen ist.

		Re	Im	Betrag,rms	Peak	
	Ableitung	433.029	2.210.337	2.252.355	3.185.311	V
	Näherung	314.806	700.546	768.028	1.086.156	V
	UT	118.223	1.509.791	1.514.413	2.141.703	V
Stro	om auf der Ableitung	-18.615	-247	18.617	26.328	Α
kc-	Koeffizient aus GSA	0,53				
Analytis	che Berechnung GS/	A sinus				
kc*M*di/	dt*l=1,19*314*0,53*9	),25m			1.828.994	V
Trennun	gsabstand aus IEC 6	62305-3 mit kc	=0,44, I=9,2	5m	0,3256	cm
Trennun	gsabstand aus IEC 6	62305-3 mit kc	=0,53, I=9,2	5m	0,3922	cm
Trennun	gsabstand mit Wert	aus GSA Ber	echnung mit	t		
s=1.139	49	cm				
Potentia	lunterschied U <sub>T</sub> -M*d	i/dt*l			312.709	V

Tabelle 5-8 Ergebnisse der Simulation mit 1 MHz und 100 Ohmm

#### Version 01/12/2015



Bild 5-33 Erdoberflächenpotential in 3 D Darstellung. Berechnung für  $\rho_E$  = 100 Ohmm und 50 kA 0,25/100 entsprechend 1 MHz.



Bild 5-34 Erdoberflächenpotential in 3 D Darstellung mit größerer Auflösung Berechnung für  $\rho_{E}$  = 100 Ohmm und 50 kA 0,25/100 entsprechend 1 MHz.

#### Version 01/12/2015



Bild 5-35 Magnetische Feldstärke in 3 D Darstellung Berechnung für  $\rho_E$  = 100 Ohmm und 50 kA 0,25/100 entsprechend 1 MHz.



Bild 5-36 Verlauf des Erdoberflächenpotentials auf der im Bild dargestellten gestrichelten Linie. Berechnung für  $\rho_E$  = 100 Ohmm und 50 kA 0,25/100 entsprechend 1 MHz.


Bild 5-37 Potentialverlauf entlang der Ableitung ausgehend von der Erdoberfläche bis zu einer Höhe von 9 m oberhalb Erdoberfläche. Gesamtlänge der Ableitung: 9,25 m. Berechnung für  $\rho_E$  = 100 Ohmm und 50 kA 0,25/100 entsprechend 1 MHz.



Bild 5-38 Potentialverlauf entlang der Näherung ausgehend von der Erdoberfläche bis zu einer Höhe von 9,25 m oberhalb Erdoberfläche. Berechnung für  $\rho_E$  = 100 Ohmm und 50 kA 0,25/100 entsprechend 1 MHz. Hinweis: Für die Trennungsabstandsberechnung ist die Länge der Ableitung von 0,25 m +9m maßgebend.



Bild 5-39 Strom entlang der Näherung ausgehend von der Erdoberfläche bis zu einer Höhe von 9,25 m oberhalb Erdoberfläche. Berechnung für  $\rho_E$  = 100 Ohmm und 50 kA 0,25/100 entsprechend 1 MHz. Hinweis:

#### 5.2.1.2.2 Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 1 MHz bzw. 314kA/µs

Die Ergebnisse sind ähnlich denen für 100 Ohmm. Daher werden die Verläufe hier nicht wiederholt, sondern nur die deutlich unterschiedlichen Effekte. Das Erdoberflächenpotential in Bild 5-40 ist deutlich unterschiedlich. Bedingt durch den hohen spezifischen Bodenwiderstand erfolgt eine schnellere Wanderwellenausbreitung im Erdreich. Dies ist auch am Magnetfeld in Bild 5-41 zu erkennen, das ein direkter Indikator für die Stromaufteilung auf die einzelnen Ableitungen darstellt.

Hier stellt sich ein neues kc von 0,49 gegenüber 0,53 für 100 Ohmm ein. Es fließt daher weniger Strom in die Ableitung, andererseits ist das absolute Potential der Ableitung natürlich höher.

Die Ergebnisse der Simulation im Vergleich zu analytischen Berechnungen zeigt Tabelle 5-9

		Re	Im	Betrag,rms	Peak	
	Ableitung	1.172.950	2.040.901	2.353.952	3.328.990	V
	Näherung	1.082.070	581.072	1.228.218	1.736.963	V
	UT	90.880	1.459.829	1.462.655	2.068.507	V
Str	om auf der Ableitung	-17.449	-348	17.452	24.682	А
kc	-Koeffizient aus GSA	0,49				
Analytische						
kc*M*di/dt*	l=1,19*314*0,49*9,25	m			1.714.620	V
Trennungsa	abstand aus IEC 6230	)5-3 mit kc=0	,44, I=9,25m	า	0,3256	cm
Trennungsa	abstand aus IEC 6230	)5-3 mit kc=0	,49, I=9,25m	า	0,3626	cm
Trennungsabstand mit Wert aus GSA Berechnung					47,4	cm
Potentialun	terschied U <sub>T</sub> -M*di/dt*	1			353.886	V

Tabelle 5-9 Ergebnisse der Simulation mit 1 MHz und 1000 Ohmm.

#### Version 01/12/2015



Bild 5-40 Erdoberflächenpotential in 3 D Darstellung. Berechnung für  $\rho_E$  = 1000 Ohmm und 50 kA 0,25/100 entsprechend 1 MHz.



Bild 5-41 Magnetische Feldstärke in 3 D Darstellung Berechnung für  $\rho_E$  = 1000 Ohmm und 50 kA 0,25/100 entsprechend 1 MHz.



Bild 5-42 Strom entlang der Näherung ausgehend von der Erdoberfläche bis zu einer Höhe von 9,25 m oberhalb Erdoberfläche. Berechnung für  $\rho_E$  = 1000 Ohmm und 50 kA 0,25/100 entsprechend 1 MHz.

#### 5.2.1.3 Berechnung für Klasse 1, 100 kA, 1/200

Die Berechnung für den Stoßstrom 1/200 erfolgt mit Hinblick auf die Tatsache, dass die Steilheit zwar nur noch die Hälfte des 0,25/100 Impulses beträgt, andererseits aber die Spannungsfestigkeit um mehr als die Hälfte absinkt, siehe Bild 7-3.

Es soll daher festgestellt werden, ob der 1/200 Impuls der kritische Fall ist.

#### 5.2.1.3.1 Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs

Das Erdoberflächenpotential in Bild 5-43 zeigt einen asymmetrischen Verlauf.

Die Stromaufteilung auf einzelne Ableitungen lässt sich anhand des Magnetfeldes gut visualisieren, siehe Bild 5-44.

Mit dem Programm GSA\_FD lassen sich jetzt die Potentialverläufe einzelner Leiter darstellen. Dabei sind Betrag, Realteil und Imaginärteil einzeln abzulesen. Die Verläufe sind in Bild 5-45 und Bild 5-46 dargestellt. Die Spannung U<sub>T</sub> an der Näherung ergibt sich dann unter Berücksichtigung von Real- und Imaginärteil aus der Differenz der Potentiale an den entsprechenden Stellen.

Für die Ermittlung der Trennungsabstände ist hier aber **die Stoßkennlinie für 1/200** zu verwenden, vergl. Abschnitt 7.2. Die Durchschlagspannung für eine Stab-Stab-Funkenstrecke von 1 m Schlagweite reduziert sich bei 1/200 auf 1200 kV/m.

Die Ergebnisse der Simulation im Vergleich zu analytischen Berechnungen zeigt Tabelle 5-10

Tabelle 5-10 Ergebnisse der Simulation mit 0,25 MHz und 100 Ohmm

	Re	Im	Betrag,rms	Peak	
Ableitung	334.121	1.143.785	1.191.588	1.685.159	V
Näherung	252.771	402.866	475.599	672.598	V
UT	81.350	740.919	745.372	1.054.115	V
Strom auf der Ableitung	-33.226	-1.206	33.248	47.020	Α
kc-Koeffizient aus GSA	0,47				
Analytische Berechnung GSA	816.611	V			
Trennungsabstand mit Wert	68,4	cm			
Potentialunterschied UT - M*di	237.504	V			



Bild 5-43 Erdoberflächenpotential in 3 D Darstellung. Berechnung für  $\rho_E$  = 100 Ohmm und 100 kA 1/200 entsprechend 0,25 MHz.



Bild 5-44 Magnetfeld in 3 D Darstellung. Berechnung für  $\rho_E$  = 100 Ohmm und 100 kA 1/200 entsprechend 0,25 MHz.



Bild 5-45 Potentialverlauf entlang der Ableitung ausgehend von der Erdoberfläche bis zu einer Höhe von 9 m oberhalb Erdoberfläche. Gesamtlänge der Ableitung: 9,25 m. Berechnung für  $\rho_E$  = 100 Ohmm und 100 kA 1/200 entsprechend 0,25 MHz.



Bild 5-46 Potentialverlauf entlang der Näherung ausgehend von der Erdoberfläche bis zu einer Höhe von 9,25 m oberhalb Erdoberfläche. Berechnung für  $\rho_E$  = 100 Ohmm und 100 kA 1/200 entsprechend 0,25 MHz. Hinweis: Für die Trennungsabstandsberechnung ist die Länge der Ableitung von 0,25 m +9m maßgebend.

#### 5.2.1.3.2 Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom, 0,25 MHz bzw. 157kA/µs

Das Erdoberflächenpotential in Bild 5-47 zeigt einen ausgeglichenen Verlauf.

Die Stromaufteilung auf einzelne Ableitungen lässt sich anhand des Magnetfeldes gut visualisieren, siehe Bild 5-48.

Mit dem Programm GSA\_FD lassen sich jetzt die Potentialverläufe einzelner Leiter darstellen. Dabei sind Betrag, Realteil und Imaginärteil einzeln abzulesen. Die Verläufe sind in Bild 5-49 und Bild 5-50 dargestellt.

Die Spannung  $U_T$  an der Näherung ergibt sich dann unter Berücksichtigung von Real- und Imaginärteil aus der Differenz der Potentiale an den entsprechenden Stellen.

Für die Ermittlung der Trennungsabstände ist hier aber **die Stoßkennlinie für 1/200** zu verwenden, vergl. Abschnitt 7.2. Die Durchschlagspannung für eine Stab-Stab-Funkenstrecke von 1 m Schlagweite reduziert sich bei 1/200 auf 1200 kV/m.

Es ergibt sich ein Trennungsabstand von 75,5 cm. Wegen des größeren spezifischen Bodenwiderstands ergibt sich ein kc-Koeffizient von 0,44, d.h in der Ableitung fließ etwas weniger Strom.

Die Ergebnisse der Simulation im Vergleich zu analytischen Berechnungen zeigt Tabelle 5-11

Tabelle 5-11 Ergebnisse der Simulation mit 0,25 MHz und 1000 Ohmm

	Re	Im	Betrag,rms	Peak	
Ableitung	1.385.716	1.202.253	1.834.563	2.594.464	V
Näherung	1.310.324	566.160	1.427.405	2.018.656	V
UT	75.392	636.093	640.545	905.868	V
Strom auf der Ableitung	-30.885	-613	30.891	43.687	Α
kc-Koeffizient aus GSA	0,44				

Analytische Berechnung GSA sinus kc*M*di/dt*l=1,19*157*0,47*9,25m	758.725	V
Trennungsabstand mit Wert aus GSA	58,75	cr

Potentialunterschied  $U_T$  -M\*di/dt\*l

**58,75** cm 147.143 V



Bild 5-47 Erdoberflächenpotential in 3 D Darstellung. Berechnung für  $\rho_E$  = 1000 Ohmm und 100 kA 1/200 entsprechend 0,25 MHz.

#### Version 01/12/2015



Bild 5-48 Magnetfeld in 3 D Darstellung. Berechnung für  $\rho_{\text{E}}$  = 1000 Ohmm und 100 kA 1/200 entsprechend 0,25 MHz.



Bild 5-49 Potentialverlauf entlang der Ableitung ausgehend von der Erdoberfläche bis zu einer Höhe von 9 m oberhalb Erdoberfläche. Gesamtlänge der Ableitung: 9,25 m. Berechnung für  $\rho_E$  = 1000 Ohmm und 100 kA 1/200 entsprechend 0,25 MHz.



Bild 5-50 Potentialverlauf entlang der Näherung ausgehend von der Erdoberfläche bis zu einer Höhe von 9,25 m oberhalb Erdoberfläche. Berechnung für  $\rho_E$  = 1000 Ohmm und 100 kA 1/200 entsprechend 0,25 MHz. Hinweis: Für die Trennungsabstandsberechnung ist aber die Länge der Ableitung von 0,25 m +9m maßgebend.

#### 5.2.1.4 Vergleich der Ergebnisse

Tabelle 5-12 Vergleich der Ergebnisse.

	di/dt	M* Spannung an Trennstelle		Spannung Trennun M* an Trennstelle Abstar		ungs- tand
			UT		S <sup>1)</sup>	
	kA/µs	μH/m <sup>KV</sup>		r	n	
		0,25/100	100 Ohmm	1000 Ohmm	100 Ohmm	1000 Ohmm
IEC Methode (Zischank) Rampenmethode Mit kc=0,44	200	1,2	975 <sup>1)</sup>		0,325	
Simulation mit GSA_FD mit 1 MHz	314	1,2	2141	2068	0,49	0,47
		1/200 100 kA				
Simulation mit GSA_FD mit 0,25 MHz	157	1,2	1054	906	0,68	0,59

1) Der geringere Wert bei 0,25 MHz gegenüber 1 MHz resultiert aus der Stoßkennlinie, siehe Abschnitt 7.3.



Bild 5-51 Berechnete Trennungsabstände für das Gebäude mit Näherung nach IEC 62305-3

Tabelle 5-13 Vergleichende Darstellung der Erdoberflächenpotentiale und der Magnetfelder auf der Erdoberfläche für das Gebäude mit Näherung nach IEC 62305-3



# 5.2.2 Trennungsabstandsberechnung an einem komplexen Gebäude mit Näherung in großem Abstand von der Ableitung

#### 5.2.2.1 Modellgeometrie

Das untersuchte Gebäude mit den Abmessungen 45m\*15m\*10m zeigt Bild 5-52. Es steht auf einem Maschengitter mit der Maschenweite 1,5m x 1,5m. Das Maschengitter ist in 0,25m Tiefe angeordnet. Eine Näherung ist gemäß Bild 5-53 in einem Abstand von 0,58 m angeordnet und etwa 45 m entfernt an das Erdungsgitter angeschlossen. Der Abstand von 0,58 cm ergibt sich iterativ durch Berechnung des notwendigen Trennungsabstands mit GSA\_FD.

Nur zum Vergleich: Die Gegeninduktivität beträgt:

$$M' = \frac{1,256\mu H / m}{2\pi} \cdot ln \frac{44,5}{0,005} = 1,82\mu H / m$$
 Gleichung 5-6

Eine einfache analytische Berechnung der induzierten Spannung ist hier nicht mehr möglich, da von den anderen Ableitungen Magnetfelder wirken, die mit einem anderen Strom verkoppelt sind.



Bild 5-52 Anordnung entsprechend dem Hintergrund der Berechnung nach IEC 62305-3 mit M´=1,81µH/m bei einem Abstand von 0,58 m zwischen Ableitung und Näherung. Durchmesser der Ableitung und der Näherung: 10mm Kupfer.



Bild 5-53 Detailansicht der Anordnung in Bild 5-38 nach dem Hintergrund der Berechnung nach IEC 62305-3 mit M´=1,8µH/m bei einem Abstand von 0,58 m zwischen Ableitung und Näherung. Durchmesser der Ableitung und der Näherung: 10mm Kupfer. Länge I :9,25 m, von der Näherung bis zum Anschluss an das Erdungsgitter.



Bild 5-54 Wie Bild 5-52, jedoch isometrische Darstellung.

#### 5.2.2.2 Berechnung für Klasse 1 50 kA 0,25/100

#### 5.2.2.2.1 Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, , Sinusstrom 1 MHz bzw. 314 kA/µs

Das Erdoberflächenpotential ist in diesem Falle identisch mit dem in Bild 5-33 und Bild 5-34 dargestellten stark asymmetrischen Verlauf.

Mit dem Programm GSA\_FD lassen sich jetzt die Potential- und Stromverläufe sowie das Magnetfeld auf der Erdoberfläche einzelner Leiter darstellen. Dabei sind Betrag, Realteil und Imaginärteil einzeln abzulesen. Die Verläufe sind in Bild 5-55 und Bild 5-60 dargestellt. Die Spannung U<sub>T</sub> an der Näherung ergibt sich dann unter Berücksichtigung von Real- und Imaginärteil aus der Differenz der Potentiale an den entsprechenden Stellen.

Die Stromverläufe auf den beiden Ableitungen, vergl. Bild 5-56 bis Bild 5-58 zeigen eine Asymmetrie. Dies macht deutlich, dass eine analytische Berechnung allein mit der Gegeninduktivität nicht zielführend ist. Die Auswertung zeigt Tabelle 5-14

Tabelle 5-14 Ergebnisse der Simulation mit 1 MHz und 100 Ohmm.

Potential	Re	Im	Betrag,rms	Peak	
2.167.710	433.0	21 2.203.681	2.245.822	3.176.072	V
496.197	281.7	436.161	519.250	734.330	V
U <sub>T</sub>	151.2	1.767.520	1.773.981	2.508.788	V
Strom auf der Ableitung kc-Koeffizient aus GSA	-18.6 <b>0,5</b>	15 -247 2 <b>7</b>	18.617	26.328	Α

#### Trennungsabstand aus GSA Berechnung

57,4 cm



Bild 5-55 Erdoberflächenpotential in 3 D Darstellung. Berechnung für  $\rho_{E}$  = 100 Ohmm und 50 kA 0,25/100 entsprechend 1 MHz.

#### Version 01/12/2015



Bild 5-56 Magnetfeld in 3 D Darstellung. Berechnung für  $\rho_{E}$  = 100 Ohmm und 50 kA 0,25/100 entsprechend 1 MHz.



Bild 5-57 Darstellung der Stromverteilung auf der Ableitung 1-2 gemäß Bild 5-56



Bild 5-58 Darstellung der Stromverteilung auf der Ableitung 1-3 gemäß Bild 5-56



Bild 5-59 Potentialverlauf entlang der Ableitung ausgehend von der Erdoberfläche bis zu einer Höhe von 9 m oberhalb Erdoberfläche. Gesamtlänge der Ableitung: 9,25 m. Berechnung für  $\rho_E$  = 100 Ohmm und 50 kA 0,25/100 entsprechend 1 MHz. (Hinweis: Im Programm ist die Ableitung gezählt von 25 cm unterhalb Erde bis 9 m oberhalb Erde. Daher wird hier 8,75m angezeigt)



Bild 5-60 Potentialverlauf entlang der Näherung ausgehend von der Erdoberfläche bis zu einer Höhe von 9 m oberhalb Erdoberfläche folgend etwa 45 m bis zur Näherung an der Ableitung. Berechnung für  $\rho_E$  = 100 Ohmm und 50 kA 0,25/100 entsprechend 1 MHz.:

67,8 cm

#### 5.2.2.2.2 Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom , 1 MHz bzw 314 kA/ $\mu$ s

Das Erdoberflächenpotential verläuft bei 1000 Ohmm schon etwas gleichförmiger, wie in Bild 5-61 dargestellt.

Mit dem Programm GSA\_FD lassen sich jetzt die Potential- und Stromverläufe sowie das Magnetfeld auf der Erdoberfläche einzelner Leiter darstellen. Dabei sind Betrag, Realteil und Imaginärteil einzeln abzulesen. Die zunehmend gleichmäßige Stromaufteilung auf die einzelnen Ableitungen zeigt das Magnetfeld an der Erdoberfläche in Bild 5-62. Die Auswertung zeigt Tabelle 5-15.

Es ergibt sich ein größerer Trennungsabstand von 67,8 cm.

Tabelle 5-15 Ergebnisse der Simulation mit 1 MHz und 1000 Ohmm.

		Re	lm	Betrag,rms	Peak	
Ab	oleitung	1.258.466	2.304.103	2.625.381	3.712.850	V
Nä	äherung	914.490	236.269	944.518	1.335.751	V
U	Г	343.976	2.067.834	2.096.248	2.964.543	V
Strom auf der A	bleitung	-17449	-348	17452	24682	
kc-Koeffizient a	aus GSA	0,49				

Trennungsabstand aus GSA Berechnung



Bild 5-61 Erdoberflächenpotential in 3 D Darstellung. Berechnung für  $\rho_E$  = 1000 Ohmm und 50 kA 0,25/100 entsprechend 1 MHz.



Bild 5-62 Magnetfeld in 3 D Darstellung. Berechnung für  $\rho_E$  = 1000 Ohmm und 50 kA 0,25/100 entsprechend 1 MHz.



Bild 5-63 Potentialverlauf entlang der Ableitung ausgehend von der Erdoberfläche bis zu einer Höhe von 9 m oberhalb Erdoberfläche. Gesamtlänge der Ableitung: 9,25 m. Berechnung für  $\rho_E$  = 1000 Ohmm und 50 kA 0,25/100 entsprechend 1 MHz. (Hinweis: Im Programm ist die Ableitung gezählt von 25 cm unterhalb Erde bis 9 m oberhalb Erde. Daher wird hier 8,75m angezeigt)



Bild 5-64 Potentialverlauf entlang der Näherung ausgehend von der Erdoberfläche bis zu einer Höhe von 9 m oberhalb Erdoberfläche folgend etwa 45 m bis zur Näherung an der Ableitung. Berechnung für  $\rho_E$  = 1000 Ohmm und 50 kA 0,25/100 entsprechend 1 MHz.:



Bild 5-65 Stromverlauf entlang der Näherung ausgehend von der Erdoberfläche bis zu einer Höhe von 9 m oberhalb Erdoberfläche folgend etwa 45 m bis zur Näherung an der Ableitung. Berechnung für  $\rho_E$  = 1000 Ohmm und 50 kA 0,25/100 entsprechend 1 MHz.:

#### 5.2.2.3 Berechnungen für Klasse 1, 100 kA, 1/200

#### 5.2.2.3.1 Simulationsergebnissee für 100 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs

Das Erdoberflächenpotential zeigt in Bild 5-66 einen asymmetrischen Verlauf.

Mit dem Programm GSA\_FD lassen sich jetzt die Potential- und Stromverläufe sowie das Magnetfeld auf der Erdoberfläche einzelner Leiter darstellen. Dabei sind Betrag, Realteil und Imaginärteil einzeln abzulesen. Die

Verläufe sind in Bild 5-59und Bild 5-60 dargestellt. Die Spannung U<sub>T</sub> an der Näherung ergibt sich dann unter Berücksichtigung von Real-und Imaginärteil aus der Differenz der Potentiale an den entsprechenden Stellen.

Für die Ermittlung der Trennungsabstände ist hier aber **die Stoßkennlinie für 1/200** zu verwenden, vergl. Abschnitt 7.2. Die Durchschlagspannung für eine Stab-Stab-Funkenstrecke von 1 m Schlagweite reduziert sich bei 1/200 auf 1200 kV. Die Ergebnisse zeigt Tabelle 5-16.

Tabelle 5-16 Ergebnisse der Simulation mit 0,25 MHz und 100 Ohmm.

	Re	Im	Betrag,rms	Peak	
Ableitung	331.837	1.103.323	1.152.145	1.629.379	V
Näherung	157.619	312.286	349.809	494.705	V
UT	174.218	791.037	809.995	1.145.506	V
Strom auf der Ableitung kc-Koeffizient aus GSA	-33.227 <b>0,47</b>	-1.169	33.248	47.019	A

Trennungsabstand mit GSA Berechnung

74,3 cm



Bild 5-66 Erdoberflächenpotential in 3 D Darstellung. Berechnung für  $\rho_E$  = 100 Ohmm und 100 kA 1/200 entsprechend 0,25 MHz.

#### Version 01/12/2015



Bild 5-67 Magnetfeld in 3 D Darstellung. Berechnung für  $\rho_{E}$  = 100 Ohmm und 100 kA 1/200 entsprechend 0,25 MHz.



Bild 5-68 Potentialverlauf entlang der Näherung ausgehend von der Erdoberfläche bis zu einer Höhe von 9 m oberhalb Erdoberfläche folgend etwa 45 m bis zur Näherung an der Ableitung. Berechnung für  $\rho_E$  = 100 Ohmm und 100 kA 1/200 entsprechend 0,25 MHz.



Bild 5-69 Potentialverlauf entlang der Näherung ausgehend von der Erdoberfläche bis zu einer Höhe von 9 m oberhalb Erdoberfläche folgend etwa 45 m bis zur Näherung an der Ableitung. Berechnung für  $\rho_E$  = 100 Ohmm und 100 kA 1/200 entsprechend 0,25 MHz.



Bild 5-70 Stromverlauf entlang der Näherung ausgehend von der Erdoberfläche bis zu einer Höhe von 9 m oberhalb Erdoberfläche folgend etwa 45 m bis zur Näherung an der Ableitung. Berechnung für  $\rho_E$  = 100 Ohmm und 100 kA 1/200 entsprechend 0,25 MHz.

#### 5.2.2.3.2 Simulationsergebnissee für 1000 Ohmm, Sinusstrom 0,25 MHz bzw. 157 kA/µs

Das Erdoberflächenpotential verläuft bei 1000 Ohmm schon etwas gleichförmiger, wie in Bild 5-70 dargestellt.

Mit dem Programm GSA\_FD lassen sich jetzt die Potential- und Stromverläufe sowie das Magnetfeld auf der Erdoberfläche einzelner Leiter darstellen. Dabei sind Betrag, Realteil und Imaginärteil einzeln abzulesen. Die zunehmend gleichmäßige Stromaufteilung auf die einzelnen Ableitungen zeigt das Magnetfeld an der Erdoberfläche in Bild 5-72. Die Auswertung zeigt Tabelle 5-17.

Es ergibt sich ein größerer Trennungsabstand von 94,8 cm.

Tabelle 5-17 Ergebnisse der Simulation mit 0,25 MHz und 1000 Ohmm.

Strom auf der Ableitung	-30.890	-603	30.896	43.693	Α
kc-Koeffizient aus GSA	0,44				
Trennungsabstand aus GSA Bere	chnung mit			94,8	cm



Bild 5-71 Erdoberflächenpotential in 3 D Darstellung. Berechnung für  $\rho_E$  = 1000 Ohmm und 100 kA 1/200 entsprechend 0,25 MHz.

#### Version 01/12/2015



Bild 5-72 Magnetfeld in 3 D Darstellung. Berechnung für  $\rho_{E}$  = 1000 Ohmm und 100 kA 1/200 entsprechend 0,25 MHz.



Bild 5-73 Potentialverlauf entlang der Ableitung ausgehend von der Erdoberfläche bis zu einer Höhe von 9 m oberhalb Erdoberfläche. Gesamtlänge der Ableitung: 9,25 m. Berechnung für  $\rho_E$  = 1000 Ohmm und 100 kA 1/200 entsprechend 0,25 MHz.



Bild 5-74 Potentialverlauf entlang der Näherung ausgehend von der Erdoberfläche bis zu einer Höhe von 9 m oberhalb Erdoberfläche folgend etwa 45 m bis zur Näherung an der Ableitung. Gesamtlänge der Ableitung: 9,25 m. Berechnung für  $\rho_E$  = 1000 Ohmm und 100 kA 1/200 entsprechend 0,25 MHz.



Bild 5-75 Stromverlauf entlang der Näherung ausgehend von der Erdoberfläche bis zu einer Höhe von 9 m oberhalb Erdoberfläche folgend etwa 45 m bis zur Näherung an der Ableitung. Gesamtlänge der Ableitung: 9,25 m. Berechnung für  $\rho_E$  = 1000 Ohmm und 100 kA 1/200 entsprechend 0,25 MHz.

#### 5.2.2.4 Vergleich der Ergebnisse

Tabelle 5-18 Vergleich der Ergebnisse.

	di/dt	М*	Spannung an Trennstelle		Trennungs- Abstand	
			U	Ι <sub>Τ</sub>	S	
	kA/µs	μH/m	k	V	r	n
		0,25/100	100 Ohmm	1000 Ohmm	100 Ohmm	1000 Ohmm
IEC Methode (Zischank) Rampenmethode Mit kc=0,44	200	1,2	925 <sup>1)</sup>		0,325	
Simulation mit GSA_FD mit 1 MHz	314	1,82 <sup>2)</sup>	2508	2964	0,57	0,68
		1/200 100 kA				
Simulation mit GSA_FD mit 0,25 MHz	157	1,82 <sup>2)</sup>	1145	1461	0,74	0,95

1) Der geringere Wert gegenüber 1 MHz resultiert aus der Stoßkennlinie. Die Durchschlagspannung ist bei 1 MHz mit 314kA/µs deutlich größer gegenüber 200kA/µs.

2) Wert dient nur zur Orientierung, nicht zur Berechnung.



Bild 5-76 Berechnete Trennungsabstände für das Gebäude mit großer Näherung.

Tabelle 5-19 Vergleichende Darstellung der Erdoberflächenpotentiale und der Magnetfelder für das Gebäude mit großer Näherung



## 6 Literatur

Meppelink Review Trennungsabstandsberechnung

Meppelink VDEA-BB 2015 Vortrag Neu Ulm.

Heidler, Zischank: NECESSARY SEPARATION DISTANCES FOR LIGHTNING PROTECTION SYSTEMS - IEC 62305-3 REVISITED X International Symposium on Lightning Protection- Curitiba, Brazil, 2009.

Thione in: Ragaller : Surges in High voltage Networks, Seite 200; Plenum Press 1980,

# 7 Anhang

## 7.1 Kopplung zwischen Ableitung und der Näherungsleitung

Die elektromagnetische Kopplung zwischen einer stromführenden Ableitung und einer Näherungsleitung ist durch galvanische Kopplung im Erdreich, kapazitive Kopplung und induktive Kopplung gegeben. Dabei ist auch zu beachten, dass die Ableitung als auch die Näherung (im Erdreich und oberhalb Erde) einen ortsabhängigen Strom führt.

Eine einfache Berechnung allein durch die magnetische Kopplung ist daher bei komplexen Trennungsanordnungen nicht zielführend.

Bild 7-1 zeigt ein Modell der Kopplung ohne Berücksichtigung der Strahlungskopplung durch eletromagnetische Wellen.



Bild 7-1 Einfaches Modell der Kopplung zwischen der Ableitung und der Näherung. Darstellung ohne Einfluss der Strahlungskopplung.

### 7.2 Stoßkennlinie für Trennungsanordnung nach Zischank

Nach einer Veröffentlichung von Thione in: Ragaller : Surges in High voltage Networks, Seite 200; Plenum Press 1980, kann die Durchschlagspannung V<sub>d</sub> einer Stab-Stab-Funkenstrecke wie folgt berechnet werden.

Die Gültigkeit dieser Berechnungsmethode wurde durch Messungen im Labor an einer Funkenstrecke mit 0,25 cm bestätigt, siehe Bild 7-2 .

Diese Methode ist in der IEC 62305-3- Trennungsabstandsberechnung hinterlegt. Diese Stoßkennlinie gilt auch für einen Sinusstrom mit einer äquivalenten Frequenz des in IEC 62305-1 angegebenen Stoßstroms (Heidlerfunktion).

$$V_d(T_C) = V_d(T_1) = \frac{d}{[m]} \cdot 600 \text{kV} \cdot \left(1 + \frac{1}{T_1 / [\mu \text{s}]}\right) \quad \text{Gleichung 7-1}$$

Bild 7-3 zeigt die Stoßkennlinie einer Anordnung und die korrespondierenden Durchschlagspannungen für 0,25/100 und 1/200 Stoßströme. Dabei wird nach Zischank ein linearer Anstieg des Stoßstroms angenommen, so dass sich für die induzierte Spannung ein Rechteckimpuls ergibt.

Tabelle 7-1 Vergleichende Berechnung der Stoßkennlinie für Rampenförmigen Strom (Grundlage der Trennungsabstandsberechnung in IEC 62305-3) und für Sinusförmigen Strom.



$$\begin{aligned} & \int_{r_{0}}^{T_{c}} (V(t) - V_{0}) \, dt = A \\ & A = (V_{b} - V_{0}) \cdot T_{c} \ fitr \ T_{0} = 0 \\ & V_{0} = 6 \cdot 10^{5} \cdot d[m] V; \ A = 0, 6 \cdot d[m] Vs \end{aligned}$$
Gleichung 7-2
Data published by Thione 1979
Vo. A: are independent from the shape of the voltage
$$\begin{aligned} & T_{c} \\ & (V(t) - V_{0}) \, dt = A \\ & T_{c} \\ & T_{c} \\ & (V(t) - V_{0}) \, dt = A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & T_{c} \\ & T_{c} \\ & (V(t) - V_{0}) \, dt = A \\ & T_{c} \\ & T_{c} \\ & (V(t) - V_{0}) \, dt = A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & T_{c} \\ & T_{c} \\ & (V(t) - V_{0}) \, dt = A \\ & T_{c} \\ & T_{c} \\ & (V_{c}(t) - V_{0} \cdot T_{c} = A f i tr \ T_{0} = 0 \\ & \text{mit } A = 0, 6 \cdot s \ und \ s = 1m \\ \text{Gleichung 7-3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & T_{c} \\ & (V_{b}(t) - V_{c}) \, dt = A \\ & T_{c} \\ & T_{c} \\ & (V_{b}(t) \cdot C_{c} - V_{0} \cdot T_{c} = A f i tr \ T_{0} = 0 \\ & \text{mit } A = 0, 6 \cdot s \ und \ s = 1m \\ \text{Gleichung 7-5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & Gleichung 7-6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & V_{b}(t) = \frac{A + V_{0} \cdot T_{c}}{T_{c} \\ & T_{c} \\ & T_{c$$

Seite 68 von 72

Die berechnete Stoßkennlinie ist für beide Impulsformen gleich.  $T_C$  entspricht der Stirnzeit  $T_1$  des Stoßstroms in IEC 62305-1

$$V_b(T_C) = 600 kV \cdot \left(1 + \frac{1}{T_C[\mu s]}\right)$$
  
Gleichung 7-8



Bild 7-2 Gemessene Stoßkennlinie für eine Schlagweite von 0,25 m.



Bild 7-3 Stoßspannungskennlinie für eine Stab-Stab-Funkenstrecke mit 1 m Schlagweite. Die Durchschlagspannung ergibt sich für die jeweiligen Steilheiten des Stoßstroms.

Tabelle 7-2 Tabellarische Übersicht der verwendeten Stoßstromimpulse bzw. deren Nachbildung durch eine sinus-Funktion.

	Frequenz	di/dt <sub>t=0</sub>	Î	T <sub>1</sub> bzw. T <sub>C</sub> = Î/di/dt <sub>t=0</sub>
	MHz	kA/μs	kA	μs
Rampenimpuls				
0,25/100		200	50	0,25
1/200		100	100	1
Sinusnachbildung				
0,25/100	1	314	50	0,15923
1/200	0,25	157	100	0,63694
Heidlerimpuls <sup>1)</sup>				
0,25/100		280 <sup>1)</sup>	50	0,17857
1/200		140 <sup>1)</sup>	100	0,71428

1) Beim Heidlerimpuls tritt die maximale Steilheit nicht zum Zeitpunkt t=0 auf.

## 7.3 Analytische Berechnung des Trennungsabstands aus der Stoßkennlinie.

Im Folgenden wird anhand der Stoßkennlinie und der analytisch berechneten induzierten Spannung der notwendige Trennungsabstand berechnet: Durch Gleichsetzen der analytisch berechneten induzierten Spannung mit der Spannung aus Stoßkennlinie folgt:

$$U_{ind}(M',l) = V_b(T_C)$$
  
$$M'[\mu H / m] \cdot l[m] \cdot \frac{di}{dt} [kA / \mu s] = 600 kV \cdot s[m] \cdot \left(1 + \frac{1}{T_C[\mu s]}\right)$$

M':Induktivität pro m Länge

*l*:Länge der Ableitung nach IEC62305-3

di / dt:maximaleStromsteilheit

s: Schlagweite bzw. Trennungsabstand

 $T_C$ : Stirnzeit des Stoßstroms

Gleichung 7-9

Nach Umstellung ergibt sich der auf die Länge der Ableitung *l* bezogene Trennungsabstand s wie folgt

$$\frac{s}{l} = \frac{M'[\mu H / m] \cdot \frac{di}{dt} [kA / \mu s]}{600 kV \cdot \left(1 + \frac{1}{T_c[\mu s]}\right)}$$

Gleichung 7-10

Ersetzt man Tc durch di/dt , folgt durch Einsetzen für den Trennungsabstand

$$s = l[m] \cdot \frac{M'[\mu H / m] \cdot}{600 kV \cdot \left(\frac{1}{\frac{di}{dt} [kA / \mu s]} + \frac{1}{\hat{I}[kA]}\right)}$$

Gleichung 7-11

di/dt	I	s/l	s für I= 9,25 m
kA/µs	kA		m
100	100	0,10	0,93
140	100	0,12	1,08
157	100	0,12	1,13
200	50	0,08	0,74
280	50	0,08	0,78
314	50	0,09	0,80



Bild 7-4 Berechneter Trennungsabstand für M`=1,2µH/m und eine Länge von 9,25 m für die Stoßströme 0,25/100, 50 kA und 1/200, 100 kA entsprechend Klasse 1 für verschiedene Stromsteilheiten.

# 7.4 Berechnung des Trennungsabstands aus den Ergebnnissen der induzierten Spannung UT mit GSA\_FD und der Stoßkennlinie.

Der notwendige Trennungsabstand ergibt sich aus der mit GSA\_FD berechneten Spannung U<sub>T</sub> und der Festigkeit einer Trennstrecke aus der Stoßkennlinie in Bild 7-3 .

$$s[m] = \frac{U_T[kV]}{600kV \cdot \left(1 + \frac{1}{T_C[\mu s]}\right)}$$

Mit der folgenden Skizze gilt :

$$\hat{I} = \left(\frac{di}{dt}\right)_{t=0} \cdot T_C$$

und für den Trennungsabstand

$$s[m] = \frac{U_T[kV]}{600kV \cdot \left(1 + \frac{\left(\frac{di}{dt}\right)_{t=0}[kA/\mu s]}{\hat{I}[kA]}\right)}$$

 $U_T$ : Mit GSA für die Stromsteilheit  $(di/dt)_{t=0}$  ermittelte Spannung Gleichung 7-12



Bild 7-5 Skizze zur Darstellung des negativen Stoßstroms, der durch eine Sinus-Funktion nachgebildet ist. Die erste Ableitung ergibt die cosinus-Funktion. Die Tangente im Nullpunkt wird mit der Geradengleichung beschrieben. Dieses Beispiel gilt für den negativen Folgestoßstrom 0,25/100 mit 50kA Scheitelwert.

Für eine Berechnung nach der angewandten Frequenz gilt:

$$\frac{di}{dt} = \hat{I} \cdot \omega \cdot \cos \omega t$$
  
für  $t = 0$  folgt :  
 $\left(\frac{di}{dt}\right)_{t=0} = \hat{I} \cdot \omega \cdot 1$ 

Einsetzen in Gleichung 7-9 ergibt

$$s[m] = \frac{U_T[kV]}{600kV \cdot (1 + 2 \cdot \pi \cdot f[MHz])}$$

 $U_T$ : Mit GSA für die Frequenz f ermittelte Spannung

Gleichung 7-13